

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Semiconductor devices –
Part 16-1: Microwave integrated circuits – Amplifiers**

**Dispositifs à semiconducteurs –
Partie 16-1: Circuits intégrés hyperfréquences – Amplificateurs**

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60747-16-1:2001



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2001 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester.

If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de la CEI ou du Comité national de la CEI du pays du demandeur.

Si vous avez des questions sur le copyright de la CEI ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de la CEI de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

Useful links:

IEC publications search - www.iec.ch/searchpub

The advanced search enables you to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...).

It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available on-line and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing more than 30 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) on-line.

Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: csc@iec.ch.

A propos de la CEI

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Liens utiles:

Recherche de publications CEI - www.iec.ch/searchpub

La recherche avancée vous permet de trouver des publications CEI en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...).

Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

Just Published CEI - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications de la CEI. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne au monde de termes électroniques et électriques. Il contient plus de 30 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans les langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) en ligne.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: csc@iec.ch.

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Semiconductor devices –
Part 16-1: Microwave integrated circuits – Amplifiers**

**Dispositifs à semiconducteurs –
Partie 16-1: Circuits intégrés hyperfréquences – Amplificateurs**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

PRICE CODE
CODE PRIX



ICS 31.080.99

ISBN 978-2-83220-356-9

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

CONTENTS

FOREWORD.....	4
1 Scope.....	6
2 Normative references	6
3 Terminology	6
4 Essential ratings and characteristics.....	8
4.1 General.....	8
4.2 Application related description.....	9
4.3 Specification of the function	10
4.4 Limiting values (absolute maximum rating system)	11
4.5 Operating conditions (within the specified operating temperature range)	13
4.6 Electrical characteristics.....	13
4.7 Mechanical and environmental ratings, characteristics and data.....	15
4.8 Additional information.....	15
5 Measuring methods	15
5.1 General.....	15
5.2 Linear (power) gain (G_{lin})	16
5.3 Linear (power) gain flatness (ΔG_{lin})	18
5.4 Power gain (G_p).....	19
5.5 (Power) gain flatness (ΔG_p)	19
5.6 (Maximum available) gain reduction (ΔG_{red})	20
5.7 Limiting output power ($P_{o(ltg)}$)	21
5.8 Output power (P_o)	22
5.9 Output power at 1 dB gain compression ($P_{o(1dB)}$)	23
5.10 Noise figure (F)	24
5.11 Intermodulation distortion (P_n/P_1) (two-tone).....	26
5.12 Power at the intercept point (for intermodulation products) ($P_{n(IP)}$)	28
5.13 Magnitude of the input reflection coefficient (input return loss) ($ s_{11} $)	29
5.14 Magnitude of the output reflection coefficient (output return loss) ($ s_{22} $)	30
5.15 Magnitude of the reverse transmission coefficient (isolation) ($ s_{12} $)	34
5.16 Conversion coefficient of amplitude modulation to phase modulation ($\alpha_{(AM-PM)}$)	35
5.17 Group delay time ($t_{d(grp)}$).....	37
5.18 Power added efficiency	38
5.19 n th order harmonic distortion ratio (P_{nth}/P_1)	40
5.20 Output noise power (P_N)	41
5.21 Spurious intensity under specified load VSWR (P_{sp}/P_o)	43

Figure 1 – Circuit for the measurements of linear gain	16
Figure 2 – Basic circuit for the measurement of the noise figure	24
Figure 3 – Basic circuit for the measurements of two-tone intermodulation distortion	26
Figure 4 – Circuit for the measurements of magnitude of input/output reflection coefficient (input/output return loss)	29
Figure 5 – Circuit for the measurement of output reflection coefficient	32
Figure 6 – Circuit for the measurement of isolation	34
Figure 7 – Basic circuit for the measurement of $\alpha_{(AM-PM)}$	35
Figure 8 – Circuit for the measurement of the power added efficiency	38
Figure 9 – Circuit for the measurements of the nth order harmonic distortion ratio	40
Figure 10 – Circuit diagram for the measurement of the output noise power	42
Figure 11 – Circuit diagram for the measurement of the spurious intensity	44

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60747-16-1:2001

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES –

Part 16-1: Microwave integrated circuits – Amplifiers

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60747-16-1 has been prepared by subcommittee 47E: Discrete semiconductor devices, of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

This bilingual version (2012-09) corresponds to the monolingual English version, published in 2001-11.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
47E/200/FDIS	47E/204/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

The French version of this standard has not been voted upon.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2004. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60747-16-1:2001

SEMICONDUCTOR DEVICES –

Part 16-1: Microwave integrated circuits – Amplifiers

1 Scope

This part of IEC 60747 provides the terminology, the essential ratings and characteristics, as well as the measuring methods for integrated circuit microwave power amplifiers.

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this part of IEC 60747. For dated references, subsequent amendments to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to agreements based on this part of IEC 60747 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. For undated references, the latest edition of the normative document referred to applies. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 60617-12:1997, *Graphical symbols for diagrams – Part 12: Binary logic elements*

IEC 60617-13:1993, *Graphical symbols for diagrams – Part 13: Analogue elements*

IEC 60747-1:1983, *Semiconductor devices – Discrete devices – Part 1: General*

IEC 60747-7:2000, *Semiconductor devices – Part 7: Bipolar transistors*

IEC 60748-2:1997, *Semiconductor devices – Integrated circuits – Part 2: Digital integrated circuits*

IEC 60748-3:1986, *Semiconductor devices – Integrated circuits – Part 3: Analogue integrated circuits*

IEC 60748-4:1997, *Semiconductor devices – Integrated circuits – Part 4: Interface integrated circuits*

3 Terminology

3.1

linear (power) gain G_{lin}

power gain in the linear region of the power transfer curve P_o (dBm) = $f(P_i)$

NOTE In this region, ΔP_o (dBm) = ΔP_i (dBm).

3.2

linear (power) gain flatness ΔG_{lin}

power gain flatness when the operating point lies in the linear region of the power transfer curve

3.3

power gain G_p , G

ratio of the output power to the input power

NOTE Usually the power gain is expressed in decibels.

3.4**(power) gain flatness ΔG_p**

difference between the maximum and minimum power gain for a specified input power in a specified frequency range

3.5**(maximum available) gain reduction ΔG_{red}**

difference in decibels between the maximum and minimum power gains that can be provided by the gain control

3.6 Output power limiting**3.6.1****output power limiting range**

range in which, for rising input power, the output power is limiting

NOTE For specification purposes, the limits of this range are specified by specified lower and upper limit values for the input power.

3.6.2**limiting output power $P_{o(ltg)}$**

output power in the range where it is limiting

3.6.3**limiting output power flatness $\Delta P_{o(ltg)}$**

difference between the maximum and minimum output power in the output power limiting range:

$$\Delta P_{o(ltg)} = P_{o(ltg, \max)} - P_{o(ltg, \min)}$$

3.7**intermodulation distortion P_n/P_1**

ratio of

the output power of the n th order component to

the output power of the fundamental component,

at a specified input power

3.8**power at the intercept point (for intermodulation products) $P_{n(IP)}$**

output power at intersection between the extrapolated output powers of the fundamental component and the n th order intermodulation components, when the extrapolation is carried out in a diagram showing the output power of the components (in decibels) as a function of the input power (in decibels)

3.9**magnitude of the input reflection coefficient (input return loss) $|s_{11}|$**

see 3.5.2.1 of IEC 60747-7

3.10**magnitude of the output reflection coefficient (output return loss) $|s_{22}|$**

see 3.5.2.2 of IEC 60747-7

3.11**magnitude of the reverse transmission coefficient (isolation) $|s_{12}|$**

see 3.5.2.4 of IEC 60747-7

3.12

conversion coefficient of amplitude modulation to phase modulation $\alpha_{(AM-PM)}$
quotient of

the phase deviation of the output signal (in degrees) by
the change in input power (in decibels) producing it

3.13

group delay time $t_{d(grp)}$

ratio of the change, with angular frequency, of the phase shift through the amplifier

NOTE Usually group delay time is very close in value to input-to-output delay time.

3.14

n th order harmonic distortion ratio P_{nth}/P_1

ratio of the power of the n th order harmonic component measured at the output port of the device to the power of the fundamental frequency measured at the output port for a specified output power

3.15

output noise power P_N

maximum noise power measured at the output port of the device within a specified bandwidth in a specified frequency range for a specified output power

3.16

spurious intensity under specified load VSWR P_{sp}/P_o

ratio of the maximum spurious power measured at the output port of the device to the power of the fundamental frequency measured at the output port under specified load VSWR

4 Essential ratings and characteristics

4.1 General

4.1.1 Circuit identification and types

4.1.1.1 Designation and types

The indication of type (device name), the category of the circuit and the technology applied should be given.

Microwave amplifiers are divided into four categories:

Type A: Low-noise type.

Type B: Auto-gain control type.

Type C: Limiting type.

Type D: Power type.

4.1.1.2 General function description

A general description of the function performed by the integrated circuit microwave amplifiers and the features for the application should be made.

4.1.1.3 Manufacturing technology

The manufacturing technology, for example, semiconductor monolithic integrated circuit, thin-film integrated circuit, micro-assembly, should be stated. This statement should include details of the semiconductor technologies such as MESFET, MISFET, Si bipolar transistor, HBT, etc.

4.1.1.4 Package identification

The following statements should be made:

- a) IEC and/or national reference number of the outline drawing, or drawing of non-standard package including terminal numbering;
- b) principal package material; for example, metal, ceramic, plastic.

4.1.1.5 Main application

The main application should be stated, if necessary. If the device has restrictive applications, these should be stated here.

4.2 Application related description

Information on the application of the integrated circuit and its relation to the associated devices should be given.

4.2.1 Conformance to system and/or interface information

It should be stated whether the integrated circuit conforms to an application system and/or interface standard or recommendation.

The detailed information about application systems, equipment and circuits such as VSAT systems, DBS receivers, microwave landing systems, etc., should also be given.

4.2.2 Overall block diagram

A block diagram of the applied systems should be given, if necessary.

4.2.3 Reference data

The most important properties to permit comparison between derivative types should be given.

4.2.4 Electrical compatibility

It should be stated whether the integrated circuit is electrically compatible with other particular integrated circuits or families of integrated circuits or whether special interfaces are required.

Details should be given of the type of the input and output circuits, for example, input/output impedances, d.c. block, open-drain, etc. Interchangeability with other devices, if any, should be given.

4.2.5 Associated devices

If applicable, the following should be stated here:

- devices necessary for correct operation (list with type number, name, and function);
- peripheral devices with direct interfacing (list with type number, name, and function).

4.3 Specification of the function

4.3.1 Detailed block diagram – Functional blocks

A detail block diagram or equivalent circuit information of the integrated circuit microwave amplifiers should be given. The block diagram should be composed of the following:

- 1) functional blocks;
- 2) mutual interconnections among the functional blocks;
- 3) individual functional units within the functional blocks;
- 4) mutual interconnections among the individual functional blocks;
- 5) function of each external connection;
- 6) interdependence between the separate functional blocks.

The block diagram should identify the function of each external connection and, where no ambiguity can arise, can also show the terminal symbols and/or numbers. If the encapsulation has metallic parts, any connection to them from external terminals should be indicated. The connections with any associated external electrical elements should be stated, where necessary.

As additional information, the complete electrical circuit diagram can be reproduced, but not necessarily with indications of the values of the circuit components. The graphical symbol for the function shall be given. This may be obtained from a catalogue of standards of graphical symbols or designed according to the rules of IEC 60617-12 or IEC 60617-13.

4.3.2 Identification and function of terminals

All terminals should be identified on the block diagram (supply terminals, input or output terminals, input/output terminals).

The terminal functions 1)-4) should be indicated in a table as follows:

Terminal number	Terminal symbol	1) Terminal designation	2) Function	Function of terminal	
				3) Input/output identification	4) Type of input/output circuit

1) Terminal name

A terminal name to indicate the function terminal should be given. Supply terminals, ground terminals, blank terminals (with abbreviation NC), non-usable terminals (with abbreviation NU) should be distinguished.

2) Function

A brief indication of the terminal function should be given.

- Each function of multi-role terminals, that is terminals that have multiple functions.
- Each function of the integrated circuit selected by mutual pin connections, programming and/or application of function selection data to the function selection pin, such as mode selection pin.

3) Input/output identification

Input, output, input/output, and multiplex input/output terminals should be distinguished.

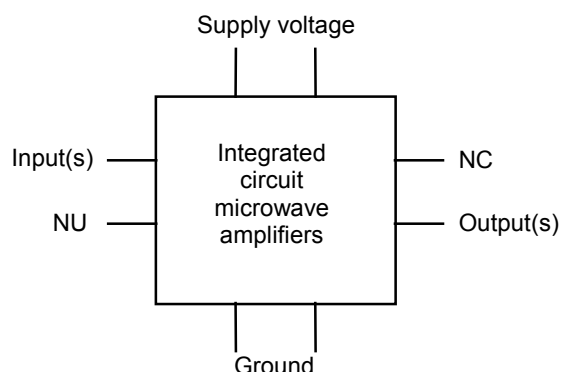
4) Type of input/output circuits

The type of the input and output circuits, for example, input/output impedances, with or without d.c. block, etc., should be distinguished.

5) Type of ground

If the baseplate of the package is used as ground, this should be stated.

Example:



4.3.3 Functional description

The function performed by the circuit should be specified, including the following information:

- basic function;
- relation to external terminals;
- operation mode (for example, set-up method, preference, etc.);
- interrupt handling.

4.3.4 Family-related characteristics

In this part, all the family-specific functional descriptions shall be stated (refer to IEC 60748-2, IEC 60748-3 and IEC 60748-4).

If ratings and characteristics and function characteristics exist for the family, the relevant part of IEC 60748 should be used (for example, for microprocessors, see IEC 60748-2, Chapter III, Section 3).

NOTE For each new device family, specific items shall be added in the relevant part of IEC 60748.

4.4 Limiting values (absolute maximum rating system)

The table of these values contains the following.

- a) Any interdependence of limiting conditions shall be specified.
- b) If externally connected and/or attached elements, for example heatsinks, have an influence on the values of the ratings, the ratings shall be prescribed for the integrated circuit with the elements connected and/or attached.
- c) If limiting values are exceeded for transient overload, the permissible excess and their duration shall be specified.
- d) Where minimum and maximum values differ during programming of the device, this should be stated.
- e) All voltages are referenced to a specified reference terminal (V_{SS} , G_{ND} , etc.).
- f) In satisfying the following clauses, if maximum and/or minimum values are quoted, the manufacturer must indicate whether he refers to the absolute magnitude or to the algebraic value of the quantity.
- g) The ratings given must cover the operation of the multi-function integrated circuit over the specified range of operating temperatures. Where such ratings are temperature-dependent, this dependence should be indicated.

4.4.1 Electrical limiting values

Limiting values should be specified as follows.

Parameters	Min.	Max.
(1) Power supply voltages	+	+
(2) Power supply currents (where appropriate)		+
(3) Input voltage(s) (where appropriate)	+	+
(4) Output voltage(s) (where appropriate)	+	+
(5) Input current(s) (where appropriate)		+
(6) Output current(s) (where appropriate)		+
(7) Other terminal voltage(s) (where appropriate)	+	+
(8) Other terminal current(s) (where appropriate)		+
(9) Voltage difference between input and output (where appropriate)	+	+
(10) Power dissipation		+

The detail specification may indicate those values within the table including note 1 and note 2.

Parameters (Note 1, Note 2)	Symbols	Min.	Max.	Unit
NOTE 1 Where appropriate, in accordance with the type of circuit considered. NOTE 2 For power supply voltage range: – limiting value(s) of the continuous voltage(s) at the supply terminal(s) with respect to a special electrical reference point; – where appropriate, limiting value between specified supply terminals; – when more than one voltage supply is required, a statement should be made as to whether the sequence in which these supplies are applied is significant: if so, the sequence should be stated; – when more than one supply is needed, it may be necessary to state the combinations of ratings for these supply voltages and currents.				

4.4.2 Temperatures

- 1) Operating temperature
- 2) Storage temperature
- 3) Channel temperature (type C and type D only)
- 4) Lead temperature (for soldering).

The detail specification may indicate those values within the table including the note.

Parameters (Note)	Symbols	Min.	Max.	Unit
NOTE Where appropriate, in accordance with the type of circuit considered.				

4.5 Operating conditions (within the specified operating temperature range)

They are not to be inspected but may be used for quality assessment purpose.

4.5.1 Power supplies positive and/or negative values

4.5.2 Initialization sequences (where appropriate)

If special initialization sequences are necessary, the power supply sequencing and the initialization procedure should be specified.

4.5.3 Input voltage(s) (where appropriate)

4.5.4 Output current(s) (where appropriate)

4.5.5 Voltage and/or current of other terminal(s)

4.5.6 External elements (where appropriate)

4.5.7 Operating temperature range

4.6 Electrical characteristics

The characteristics shall apply over the full operating temperature range, unless otherwise specified.

Each characteristic of 4.6.1 and 4.6.2 should be stated, either

- a) over the specified range of operating temperatures, or
- b) at a temperature of 25 °C, and at maximum and minimum operating temperatures.

4.6.1 Static characteristics

The parameters should be specified corresponding to the type as follows.

Parameters	Min.	Typ. ^a	Max.	Types			
				A	B	C	D
4.6.1.1 Power supply current	+	+	+	+	+	+	+
4.6.1.2 Thermal resistance			+			+	+
^a Optional							

The detail specification may indicate those values within the table.

Characteristics	Symbols	Conditions	Min.	Typ. ^a	Max.	Unit
^a Optional						

4.6.2 Dynamic or a.c. characteristics

Each dynamic or a.c. electrical characteristic should be stated under specified electrical worst-case conditions with respect to the recommended range of supply voltages, as stated in 4.5.1.

Parameters		Min.	Max.	Types			
				A	B	C	D
4.6.2.1	Linear gain	+		+	+		+
4.6.2.2	Linear gain flatness		+	+	+		+
4.6.2.3	Power gain	+			+		+
4.6.2.4	Power gain flatness		+		+		+
4.6.2.5	Gain reduction	+			+		
4.6.2.6	Output power	+			+		+
4.6.2.7	Output power at 1 dB gain compression	+			+		+
4.6.2.8	Limiting output power	+	+			+	
4.6.2.9	Limiting output power flatness		+			+	
4.6.2.10	Intermodulation distortion		+			+	+
4.6.2.11	Power at intercept point	+				+	+
4.6.2.12	Noise figure		+	+			
4.6.2.13	Magnitude of the input reflection coefficient (input return loss)	+		+	+	+	+
4.6.2.14	Magnitude of the output reflection coefficient (output return loss)	+		+	+		+ ^b
4.6.2.15	Magnitude of the reverse transmission coefficient (isolation)	+		+	+	+	+
4.6.2.16	Conversion coefficient of amplitude modulation to phase modulation (where appropriate)		+			+	+
4.6.2.17	Group delay time (where appropriate)		+		+	+	+
4.6.2.18	Time constant for automatic gain control ^a						
4.6.2.19	Power added efficiency (where appropriate)	+					+
4.6.2.20	<i>n</i> th order harmonic distortion ratio (where appropriate) (note 2)		+				+
4.6.2.21	Output noise power (where appropriate)		+				+
4.6.2.22	Spurious intensity under specified load VSWR (where appropriate) (note 2)		+				+

NOTE 2 Generally expressed in dBc.

^b Optional. For type D, the devices are sometimes required to specify under large signal operation instead of small signal operation. Although the definition is the same for both operating conditions, the different measuring method should be employed for the parameter under large signal operation from that under small signal operation.

Characteristics	Symbols	Conditions	Min.	Typ. ^a	Max.	Unit

^a Optional

4.7 Mechanical and environmental ratings, characteristics and data

Any specific mechanical and environmental ratings applicable should be stated (see also IEC 60747-1, Chapter VI, clause 7).

4.8 Additional information

Where appropriate, the following information should be given.

4.8.1 Equivalent input and output circuit

Detailed information should be given regarding the type of the input and output circuits; for example, input/output impedances, d.c. block, open-drain, etc.

4.8.2 Internal protection

A statement should be given to indicate whether the integrated circuit contains internal protection against high static voltages or electrical fields.

4.8.3 Capacitors at terminals

If capacitors for the input/output d.c. block are needed, these capacitances should be stated.

4.8.4 Thermal resistance

4.8.5 Interconnections to other types of circuit

Where appropriate, details of the interconnections to other circuits, for example, detector circuit for AGC, sense amplifiers, buffer, should be given.

4.8.6 Effects of externally connected component(s)

Curves or data indicating the effect of externally connected component(s) that influence the characteristics may be given.

4.8.7 Recommendations for any associated device(s)

For example, decoupling of power supply to a high-frequency device should be stated.

4.8.8 Handling precautions

Where appropriate, handling precautions specific to the circuit should be stated (see also IEC 60747-1, Chapter IX).

4.8.9 Application data

4.8.10 Other application information

4.8.11 Date of issue of the data sheet

5 Measuring methods

5.1 General

5.1.1 Characteristic impedances

The input and output characteristic impedances of the measurement system, shown in the circuit in this standard, are 50 Ω . If they are not 50 Ω , they should be specified.

5.1.2 General precautions

The general precautions listed in clause 2 of IEC 60747-1, Chapter VII, Section One apply. In addition, special care should be taken to use low-ripple d.c. supplies and to decouple adequately all bias supply voltages at the frequency of measurement. Also special care about the load impedance of the test circuit should be taken to measure the output power.

The power levels are indicated by using the unit "dBm". The unit "dBm" expresses decibel referred to 1 mW.

5.1.3 Handling precautions

When handling electrostatic-sensitive devices, the handling precautions given in clause 1 of IEC 60747-1, Chapter IX, shall be observed.

5.1.4 Types

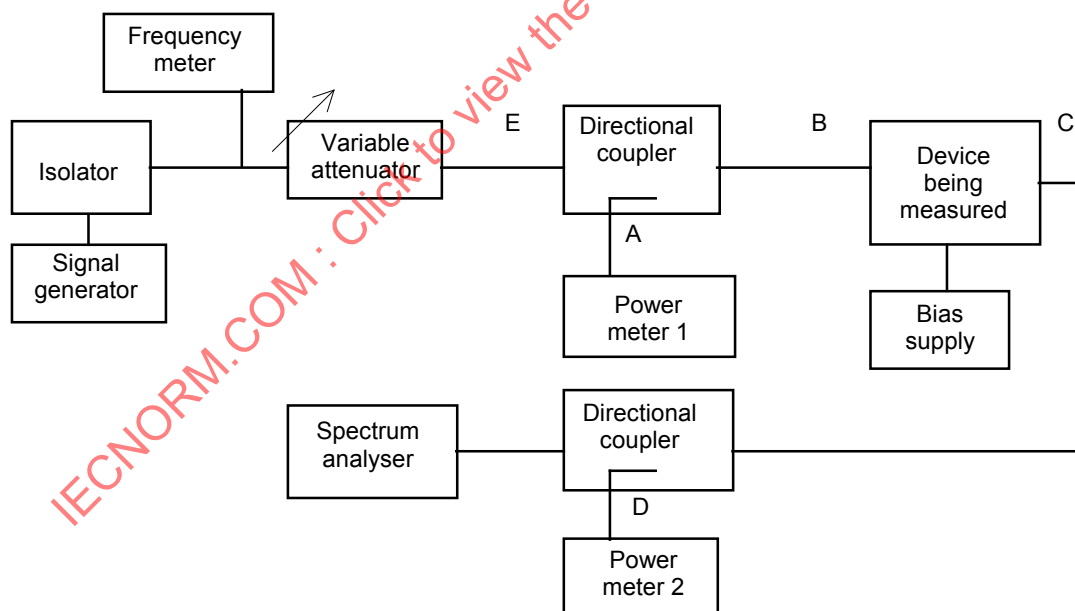
The devices in this standard are both package and chip types, measured using suitable test fixtures.

5.2 Linear (power) gain (G_{lin})

5.2.1 Purpose

To measure the linear gain under specified conditions.

5.2.2 Circuit diagram



IEC 2246/01

Figure 1 – Circuit for the measurements of linear gain

5.2.3 Principle of measurement

In the circuit diagram shown in figure 1, the input power P_i and the output power P_o of the device being measured are derived from the following equations:

$$P_i = P_1 + L_1 \quad (1)$$

$$P_o = P_2 + L_2 \quad (2)$$

where P_1 and P_2 are the value indicated by the power meters 1 and 2, respectively.

$$L_1 = L_A - L_B$$

where L_A is the loss from point E to point A and L_B is the loss from point E to point B shown in figure 1, respectively.

L_2 is the circuit loss from point C to point D shown in figure 1. P_i , P_o , P_1 and P_2 are expressed in dBm. L_1 and L_2 are expressed in decibels.

Power gain G_p in dB is derived from equation (1) and (2) as follows:

$$G_p = P_o - P_i \quad (3)$$

The linear gain G_{lin} is the power gain measured in the region where the change of the output power in dBm is the same as that of the input power.

5.2.4 Circuit description and requirements

The purpose of the isolator is to enable the power level to the device being measured to be kept constant irrespective of impedance mismatches at its input.

The circuit losses L_1 and L_2 should be measured beforehand.

5.2.5 Precautions to be observed

Oscillation, which is checked by a spectrum analyser, should be eliminated during these measurements. The termination must be capable of handling the power fed.

Harmonics or spurious responses of the signal generator should be reduced to negligible.

5.2.6 Measurement procedure

The frequency of the signal generator should be adjusted to the specified value.

The bias under specified conditions is applied.

An adequate input power is applied to the device being measured.

By varying input power, confirm that the change of the output power in dBm is the same as that of the input power.

The gain measured in the region where the change of output power is the same as that of input power is linear gain G_{lin} .

5.2.7 Specified conditions

- Ambient or reference-point temperature
- Bias conditions
- Frequency

5.3 Linear (power) gain flatness (ΔG_{lin})

5.3.1 Purpose

To measure the linear gain flatness under specified conditions.

5.3.2 Circuit diagram

See the circuit diagram shown in figure 1.

5.3.3 Principle of measurement

See the principle of measurements of 5.2.3.

Linear gain flatness is derived from the following equation.

$$\Delta G_{lin} = G_{linmax} - G_{linmin} \quad (4)$$

where G_{linmax} and G_{linmin} are maximum linear gain and minimum linear gain in the specified frequency band at the specified input power, respectively.

5.3.4 Circuit description and requirements

See the circuit description and requirements of 5.2.4.

5.3.5 Precautions to be observed

See the precautions to be observed of 5.2.5.

5.3.6 Measurement procedure

The frequency of the signal generator should be adjusted to the specified value.

The bias under specified conditions is applied.

An adequate input power level is applied to the device being measured.

By varying input power level, confirm that the change of output power in dBm is the same as that of input power.

Decide the suitable input power level for measuring linear gain.

Vary the frequency in the specified frequency band with the same input power level.

Obtain the maximum linear gain G_{linmax} and the minimum linear gain G_{linmin} in the specified frequency band.

Linear gain flatness ΔG_{lin} is derived from equation (4).

5.3.7 Specified conditions

- Ambient or reference-point temperature
- Bias conditions
- Frequency band

5.4 Power gain (G_p)

5.4.1 Purpose

To measure the power gain under specified conditions.

5.4.2 Circuit diagram

See the circuit diagram shown in figure 1.

5.4.3 Principle of measurement

See the principle of measurements of 5.2.3.

5.4.4 Circuit description and requirements

See the circuit description and requirements of 5.2.4.

5.4.5 Precautions to be observed

See the precautions to be observed of 5.2.5.

5.4.6 Measurement procedure

The frequency of the signal generator should be adjusted to the specified value.

The bias under specified conditions is applied.

The specified input power P_i is applied to the device being measured.

The output power P_o is measured.

5.4.7 Specified conditions

- Ambient or reference-point temperature
- Bias conditions
- Frequency
- Input power

5.5 (Power) gain flatness (ΔG_p)

5.5.1 Purpose

To measure the power gain flatness under specified conditions.

5.5.2 Circuit diagram

See the circuit diagram shown in figure 1.

5.5.3 Principle of measurement

See the principle of measurements of 5.2.3.

Power gain flatness is derived from the following equation.

$$\Delta G_p = G_{pmax} - G_{pmin} \quad (5)$$

where G_{pmax} and G_{pmin} are the maximum power gain and the minimum power gain in the specified frequency band at the specified input power, respectively.

5.5.4 Circuit description and requirements

See the circuit description and requirements of 5.2.4.

5.5.5 Precautions to be observed

See the precautions to be observed of 5.2.5.

5.5.6 Measurement procedure

The frequency of the signal generator should be adjusted to the specified value.

The bias under specified conditions is applied.

The input power P_i is applied to the device being measured.

The output power P_o is measured.

The power gain is calculated by equation (3).

The frequency in the specified band is varied continuously with the same input power level.

Obtain the maximum power gain G_{pmax} and the minimum power gain G_{pmin} in the specified frequency band.

Power gain flatness is derived from equation (5).

5.5.7 Specified conditions

- Ambient or reference-point temperature
- Bias conditions
- Frequency band
- Input power

5.6 (Maximum available) gain reduction (ΔG_{red})

5.6.1 Purpose

To measure the gain reduction of an AGC amplifier under specified conditions.

5.6.2 Circuit diagram

See the circuit diagram shown in figure 1, where bias supply contains AGC bias.

5.6.3 Principle of measurement

See the principle of measurements of 5.2.3.

5.6.4 Circuit description and requirements

See the circuit description and requirements of 5.2.4.

5.6.5 Precautions to be observed

See the precautions to be observed of 5.2.5.

5.6.6 Measurement procedure

The frequency of the signal generator should be adjusted to the specified value.

The bias under specified conditions is applied.

The AGC bias is set to specified values giving the maximum linear gain G_{linmax} .

An adequate input power is applied to the device being measured.

By varying input power, confirm the change of output power in dBm is the same as that of input power.

The gain, measured in the region where the change of output power is the same as that of input power, is maximum linear gain G_{linmax} .

The AGC bias is set to the specified value giving the minimum linear gain G_{linmin} .

The minimum linear gain G_{linmin} is measured in dB in the same way as above.

$$\Delta G_{red} = G_{linmax} - G_{linmin} \quad (6)$$

5.6.7 Specified conditions

- Ambient or reference-point temperature
- Bias conditions
- Frequency
- AGC bias giving the maximum linear gain and the minimum linear gain

5.7 Limiting output power ($P_{o(ltg)}$)

Limiting output power flatness ($\Delta P_{o(ltg)}$)

5.7.1 Purpose

To measure the limiting output power and limiting output power flatness under specified conditions.

5.7.2 Circuit diagram

See the circuit diagram shown in figure 1.

5.7.3 Principle of measurement

See the principle of measurements of 5.2.3.

5.7.4 Circuit description and requirements

See the circuit description and requirements of 5.2.4.

5.7.5 Precautions to be observed

See the precautions to be observed of 5.2.5.

5.7.6 Measurement procedure

The frequency of the signal generator should be adjusted to the specified value.

The bias under specified conditions is applied.

The input power P_i is applied to the device being measured.

The output power P_o is measured.

By varying the input power between the lower and upper limits of limiting range, find the minimum and maximum output powers ($P_{o(ltg,min)}$ and $P_{o(ltg,max)}$).

The limiting output power ($P_{o(ltg)}$) and limiting output power flatness ($\Delta P_{o(ltg)}$) are derived from the following equations:

$$P_{o(ltg)} = P_{o(ltg,max)} \quad (7)$$

$$\Delta P_{o(ltg)} = P_{o(ltg,max)} - P_{o(ltg,min)} \quad (8)$$

5.7.7 Specified conditions

- Ambient or reference-point temperature
- Bias conditions
- Frequency
- Lower limit of limiting range
- Upper limit of limiting range

5.8 Output power (P_o)

5.8.1 Purpose

To measure the output power under specified conditions.

5.8.2 Circuit diagram

See the circuit diagram shown in figure 1.

5.8.3 Principle of measurement

See the principle of measurements of 5.2.3.

5.8.4 Circuit description and requirements

See the circuit description and requirements of 5.2.4.

5.8.5 Precautions to be observed

See the precautions to be observed of 5.2.5.

5.8.6 Measurement procedure

The frequency of the signal generator should be adjusted to the specified value.

The specified bias conditions are applied.

The input power with the specified value is applied to the device being measured.

The output power is measured.

5.8.7 Specified conditions

- Ambient or reference-point temperature
- Bias conditions
- Frequency band
- Input power

5.9 Output power at 1 dB gain compression ($P_{O(1dB)}$)

5.9.1 Purpose

To measure the output power at 1 dB gain compression under specified conditions.

5.9.2 Circuit diagram

See the circuit diagram shown in figure 1.

5.9.3 Principle of measurement

See the principle of measurements of 5.2.3.

The output power at 1 dB gain-compression $P_{O(1dB)}$ is the value where the gain decreases by 1 dB compared with the linear gain.

5.9.4 Circuit description and requirements

See the circuit description and requirements of 5.2.4.

5.9.5 Precautions to be observed

See the precautions to be observed of 5.2.5.

5.9.6 Measurement procedure

The frequency of the signal generator should be adjusted to the specified value.

The bias under specified conditions is applied.

An adequate input power is applied to the device being measured.

By varying input power, confirm that the change of output power in decibels is the same as that of input power.

The gain, measured in the region where the change of output power in decibels is the same as that of input power, is linear gain G_{lin} .

The input power is increased up to the power at which the gain decreases by 1 dB, compared with linear gain G_{lin} .

The output power is measured at 1 dB gain compression point.

5.9.7 Specified conditions

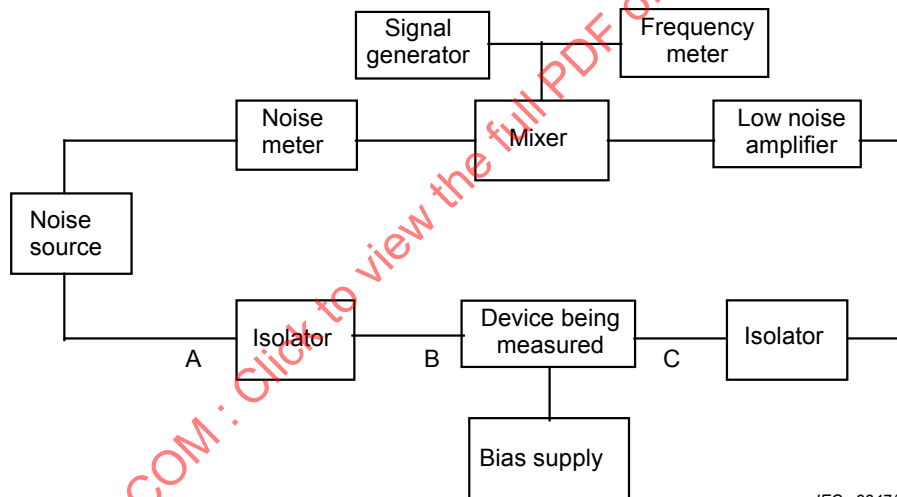
- Ambient or reference-point temperature
- Bias conditions
- Frequency

5.10 Noise figure (F)

5.10.1 Purpose

To measure the noise figure under specified conditions.

5.10.2 Circuit diagram



IEC 2247/01

Figure 2 – Basic circuit for the measurement of the noise figure

5.10.3 Principle of measurement

The noise figure F of the device being measured is derived from the following equation:

$$F = 10 \log \left[10^{(F_{12} - L_1) / 10} - \frac{10^{(F_2 / 10)} - 1}{10^{(G_{lin} / 10)}} \right] \quad (9)$$

where

- F_{12} is the overall noise figure;
- L_1 is the circuit loss from point A to B;
- F_2 is the noise figure after point C at the output stage;
- G_{lin} is the linear gain of the device being measured;
- F_{12} , F_2 , G_{lin} and L_1 are expressed in dB.

The noise figure measurement is carried out by using the hot and cold measurement method.

F_{12} , F_2 and G_{lin} are calculated as follows.

$$F_{12} = 10 \log \left(\frac{10^{ENR/10}}{(P_{N1}/P_{N2}) - 1} \right) \quad (10)$$

$$F_2 = 10 \log \left(\frac{10^{ENR/10}}{(P_{N3}/P_{N4}) - 1} \right) \quad (11)$$

$$G_{lin} = 10 \log \left(\frac{P_{N1} - P_{N2}}{P_{N3} - P_{N4}} \right) \quad (12)$$

where

ENR is the excess noise ratio of the noise source expressed in decibels;

P_{N1} and P_{N2} in W, are the measured noise powers under the hot and cold state of the noise source, respectively;

P_{N3} and P_{N4} in W, are the measured noise powers under the hot and cold state of the noise source, respectively, in the case of directly connecting point A to C in figure 2.

The temperature of the measurement is 290 K.

5.10.4 Circuit description and requirements

The circuit loss L_1 should be measured beforehand.

5.10.5 Precautions to be observed

The entire circuit must be shielded and earthed to prevent from undesired signals. For noise figure measurement under the SSB condition, careful attention must be paid to the image and other spurious responses which are generated by the mixer.

These spurious responses should be reduced to negligible.

5.10.6 Measurement procedure

The frequency of the signal generator is adjusted to the specified condition.

In order to measure the noise contribution of the measurement system, connect point A to C in figure 2 without the device being measured.

The noise power P_{N3} and P_{N4} corresponding to the noise source hot and cold, respectively, are measured.

The device being measured is inserted as shown in figure 2.

The bias under specified conditions is applied.

The noise power P_{N1} and P_{N2} corresponding to the noise source hot and cold, respectively, are measured.

The noise figure in decibels is calculated by equation (9).

NOTE Adjust to match the input and output impedance of the device being measured, when necessary.

5.10.7 Specified conditions

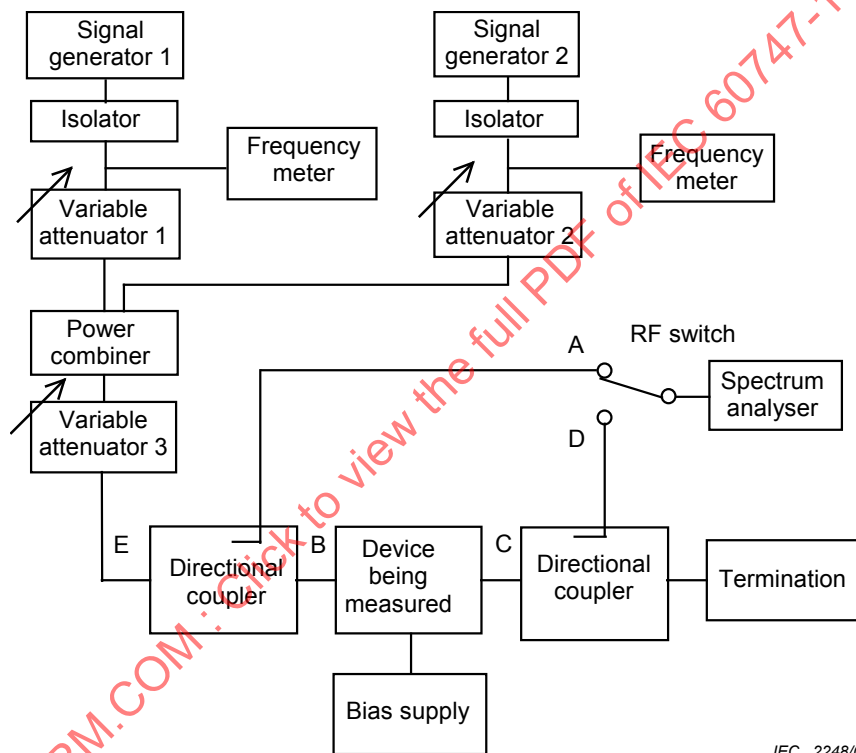
- Ambient or reference-point temperature
- Bias conditions
- Frequency
- Single-side band or double-side band

5.11 Intermodulation distortion (P_n/P_1) (two-tone)

5.11.1 Purpose

To measure the intermodulation distortion under specified conditions.

5.11.2 Circuit diagram



IEC 2248/01

Figure 3 – Basic circuit for the measurements of two-tone intermodulation distortion

5.11.3 Principle of measurement

In the circuit diagram shown in figure 3 the input power P_i , the output powers P_o and P_n of the device being measured are derived from the following equations:

$$P_i = P_a + L_1 \quad (13)$$

$$P_o = P_b + L_2 \quad (14)$$

$$P_n = P_c + L_2 \quad (15)$$

where

P_o and P_n are the output powers of the fundamental signal and the intermodulation distortion, respectively;

P_a , P_b and P_c are the values indicated by the spectrum analyser and corresponding to P_i , P_o and P_n , respectively.

L_1 is the difference between the loss L_A and L_B where L_A is the loss from point E to point A and L_B is the loss from point E to point B shown in figure 3, respectively. L_2 is the circuit loss from point C to point D shown in figure 3. P_i , P_o , P_n , P_a , P_b and P_c are expressed in dBm. L_1 and L_2 are expressed in decibels.

The intermodulation distortion, P_n/P_1 , which is expressed in dBc, is derived from equations (14) and (15) as follows:

$$P_n/P_1 = P_n - P_o = P_c - P_b \quad (16)$$

5.11.4 Circuit description and requirements

See the circuit description and requirements of 5.2.4.

The variable attenuator 3 can be eliminated.

5.11.5 Precautions to be observed

See the precautions to be observed of 5.2.5.

It is better to terminate the port D, when the switch is connected to the position A, and vice versa.

5.11.6 Measurement procedure

The bias under specified conditions is applied.

The switch is connected to position A.

The signal generator 1 is turned on, and the fundamental signal is applied to the device being measured with the specified level P_i using the spectrum analyser and the variable attenuator 1.

The signal generator 2 is turned on, and another signal is added to the device being measured with the same level as the fundamental signal using the spectrum analyser and the variable attenuator 2.

The switch is connected to position D.

The output powers P_b and P_c in dB of the fundamental signal and the intermodulation products are measured using the spectrum analyser.

The intermodulation distortion on the specified input power P_i is derived from the equations (13) to (16).

5.11.7 Specified conditions

- Ambient or reference-point temperature
- Bias conditions
- Input power
- Frequencies

5.12 Power at the intercept point (for intermodulation products) ($P_{n(IP)}$)

5.12.1 Purpose

To measure the power at the intercept point for intermodulation products under specified conditions.

5.12.2 Circuit diagram

See the circuit diagram of 5.11.2.

5.12.3 Principle of measurement

Refer the principle of measurements of 5.11.3.

5.12.4 Circuit description and requirements

See the circuit description and requirements of 5.11.4.

5.12.5 Precautions to be observed

See the precautions to be observed of 5.11.5.

5.12.6 Measurement procedure

The bias under specified conditions is applied.

The switch is connected to position A.

The signal generator 1 is turned on, and the fundamental signal is applied to the device being measured with the specified level using the spectrum analyser and the variable attenuator 1.

The signal generator 2 is turned on, and another signal is applied to the device being measured with the same level as the fundamental signal using the spectrum analyser and the variable attenuator 2.

The switch is connected to position D.

The output powers of the fundamental signal and the specified intermodulation products are measured using the spectrum analyser.

Changing the power level of the input signals using the variable attenuator 3, the above procedure is repeated within the specified range.

The data obtained are plotted.

The straight lines of the fundamental signal and the inter-modulation products in the linear region are extended.

The output power at the intercept point of the two extended lines is the power at the intercept point for the intermodulation products, i.e. second order, third order etc., under the specified conditions required in 5.12.7.

5.12.7 Specified conditions

- Ambient or reference-point temperature
- Bias conditions
- Input power
- Frequencies
- Range of input power

5.13 Magnitude of the input reflection coefficient (input return loss) ($|s_{11}|$)

5.13.1 Purpose

To measure the magnitude of the input reflection coefficient (input return loss) under specified conditions.

5.13.2 Circuit diagram

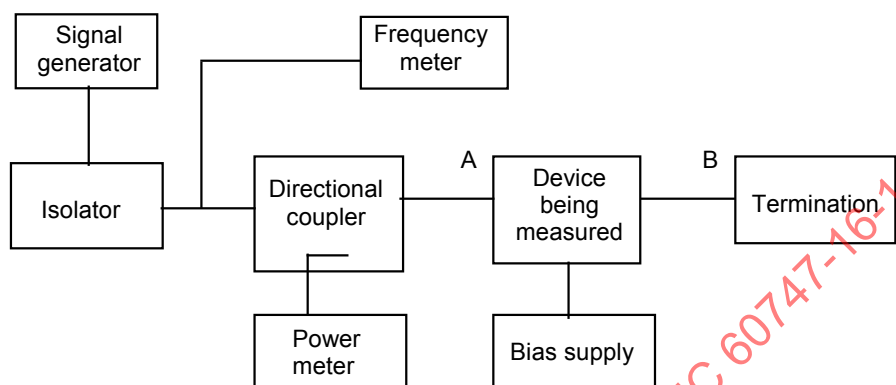


Figure 4 – Circuit for the measurements of magnitude of input/output reflection coefficient (input/output return loss)

NOTE A network analyser may be used to measure the magnitude of the reflection coefficient (input/output return loss).

5.13.3 Principle of measurement

In this measurement, the magnitude of the reflection coefficient is expressed in return loss, which is commonly in use. Thus, the sign of the return loss is opposite to that of the magnitude of the reflection coefficient in decibels.

The input return loss is derived from the following equation:

$$|s_{11}| \text{ (dB)} = P_1 \text{ (dBm)} - P_2 \text{ (dBm)} \quad (17)$$

where

P_1 is the measured power when the line at point A is either short-circuited or made open-circuit;

P_2 is the measured power when the device being measured is inserted.

5.13.4 Circuit description and requirements

The purpose of the isolator is to enable the power level to the device being measured to be kept constant, irrespective of impedance mismatches at its input.

The input port of the device being measured is connected to directional coupler, and other r.f. ports are connected to the termination.

The directivity of the directional coupler shall be sufficient to avoid undue error in the value of the return loss of the device being measured.

5.13.5 Precautions to be observed

As specified in 5.1.2.

5.13.6 Measurement procedure

The frequency of the signal generator is adjusted to the specified value.

Points A and B are disconnected.

The line at point A is either short-circuited or made open-circuit.

The reading of the power meter is recorded as P_1 .

The device being measured is inserted between points A and B.

The bias under specified conditions is applied.

The reading of the power meter is again recorded as P_2 .

The input return loss is calculated by the equation (17).

5.13.7 Specified conditions

- Ambient or reference-point temperature
- Bias conditions
- Frequency
- Input power

5.14 Magnitude of the output reflection coefficient (output return loss) ($|s_{22}|$)

The definition of the parameter of the magnitude of the output reflection coefficient $|s_{22}|$ is the only one for all the operating condition of the devices; however, it is necessary to apply the different measuring methods according to the operating conditions. Note that the value of $|s_{22}|$ depends on the operating output power level.

The method described in 5.14.1 is for the measurement under the small-signal operating condition, whereas 5.14.2 is the measuring method for the large-signal operating condition.

5.14.1 Magnitude of the output reflection coefficient (output return loss) under small-signal operating condition

5.14.1.1 Purpose

To measure the magnitude of the output reflection coefficient (output return loss) under specified small-signal conditions.

5.14.1.2 Circuit diagram

See the circuit diagram shown in figure 4.

5.14.1.3 Principle of measurement

See the principle of measurements in 5.13.3.

The output return loss is derived from the following equation:

$$|s_{22}| \text{ (dB)} = P_1 \text{ (dBm)} - P_2 \text{ (dBm)} \quad (18)$$

where

P_1 is the measured power when the line at point A is either short-circuited or made open-circuit;

P_2 is the measured power when the device being measured is inserted.

5.14.1.4 Circuit description and requirements

The purpose of the isolator is to enable the power level to the device being measured to be kept constant irrespective of impedance mismatches at its input.

The output port of the device being measured is connected to directional coupler, and other r.f. ports are connected to the termination.

The directivity of the directional coupler shall be sufficient to avoid undue error in value of the return loss of the device being measured.

5.14.1.5 Precautions to be observed

As specified in 5.1.2.

5.14.1.6 Measurement procedure

The frequency of the signal generator should be adjusted to the specified value.

Points A and B are disconnected.

The line at point A is either short-circuited or made open-circuit.

The reading of the power meter is recorded as P_1 .

The device being measured is inserted between points A and B.

The bias under specified conditions is applied.

The reading of the power meter is again recorded as P_2 .

The output return loss is calculated by the equation (18).

5.14.1.7 Specified conditions

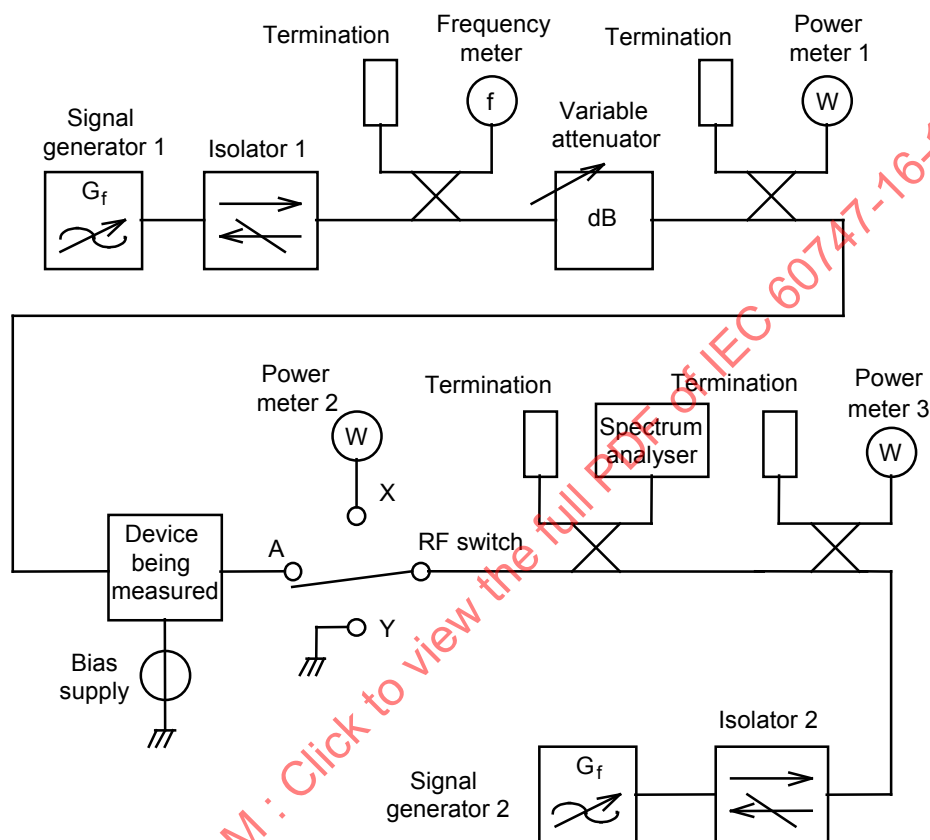
- Ambient or reference-point temperature
- Bias conditions
- Frequency
- Input power

5.14.2 Magnitude of the output reflection coefficient (output return loss) under large-signal operating condition

5.14.2.1 Purpose

To measure the magnitude of the output reflection coefficient (output return loss $|s_{22}|$) under the specified large-signal operation.

5.14.2.2 Circuit diagram



IEC 2250/01

Figure 5 – Circuit for the measurement of output reflection coefficient

5.14.2.3 Principle of measurement

See the principle of measurements in 5.13.3.

The output return loss is derived from following equation:

$$|s_{22}| \text{ (dB)} = P_1 \text{ (dBm)} - P_2 \text{ (dBm)} \quad (19)$$

where

P_1 is the value indicated on the spectrum analyser when the r.f. switch is turned to Y, in dBm;

P_2 is the value indicated on the spectrum analyser when the r.f. switch is turned to A, in dBm.

5.14.2.4 Circuit description and requirements

The purposes of the isolators are to enable the power level to the device being measured to be kept constant irrespective of impedance mismatched at its input.

The signal generator 1 supplies specified power to the device being measured, and the generator 2 is signal source to measure the output reflection coefficient $|s_{22}|$.

5.14.2.5 Precautions to be observed

Oscillation, which is checked by spectrum analyser, should be eliminated during measurement.

Harmonics or spurious responses of the signal generators should be reduced to be negligible.

Separate the frequency of signal generator 1 (f_1) and generator 2 (f_2) within the negligible of the frequency response of the device being measured.

5.14.2.6 Measurement procedure

The frequency of the signal generator 1 for input signal should be set to the specified value (f_1).

The frequency of the signal generator 2 for output reflection signal should be set to the specified value (f_2).

The r.f. switch is turned to X.

The power of signal generator 2 should be adjusted 20 dB less than the specified output power of the device being measured.

The r.f. switch is turned to Y.

The indicated power on the spectrum analyser should be recorded (P_1).

The r.f. switch is turned to A.

The biases under specified conditions are applied.

The specified power should be applied to the device being measured.

Record the indicated power on the spectrum analyser (P_2).

The output reflection coefficient $|s_{22}|$ is calculated from equation (19).

5.14.2.7 Specified conditions

- Ambient temperature or reference-point temperature
- Bias conditions
- Frequencies
- Input power
- Output power

5.15 Magnitude of the reverse transmission coefficient (isolation) ($|s_{12}|$)

5.15.1 Purpose

To measure the magnitude of the reverse transmission coefficient (isolation) under specified conditions.

5.15.2 Circuit diagram

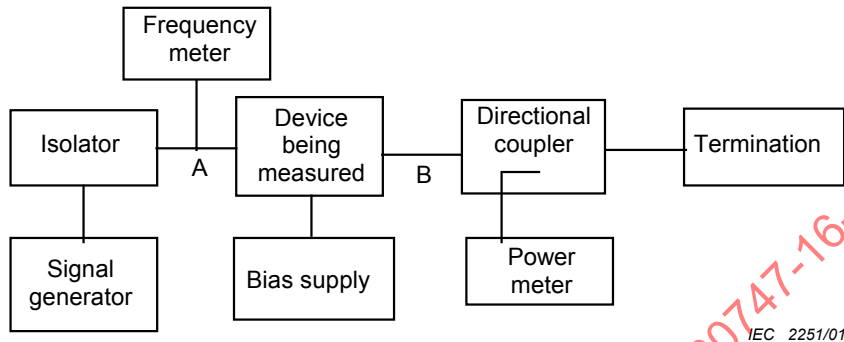


Figure 6 – Circuit for the measurement of isolation

NOTE A network analyser can also be used to measure the magnitude of the isolation.

5.15.3 Principle of measurement

The output port of the device being measured is connected to the isolator, and the input port is connected to the termination.

The input power at point A is P_1 and output power at point B is P_2 .

The isolation is derived from equation (20) as follows:

$$|s_{12}| \text{ (dB)} = P_1 \text{ (dBm)} - P_2 \text{ (dBm)} \quad (20)$$

5.15.4 Circuit description and requirements

The purpose of the isolator is to enable the power level to the device being measured to be kept constant irrespective of impedance mismatches at its output ports.

The output port of the device being measured is connected to isolator, and input port is connected to the termination.

The dynamic range of the power meter shall be large in comparison to the reverse transmission coefficient of the device under measurement.

5.15.5 Precautions to be observed

As specified in 5.1.2.

5.15.6 Measurement procedure

The frequency of the signal generator should be adjusted to the specified value.

Points A and B are connected without inserting the device being measured.

The reading of the input power indicated by meters is recorded as P_1 .

The device being measured is then inserted between points A and B.

The bias under specified conditions is applied.

The output power now recorded by the meter is noted as P_2 .

The reverse transmission coefficient is derived from the equation (20).

5.15.7 Specified conditions

- Ambient or reference-point temperature
- Bias conditions
- Frequency
- Input power

5.16 Conversion coefficient of amplitude modulation to phase modulation ($\alpha_{(AM-PM)}$)

5.16.1 Purpose

To measure the conversion coefficient of amplitude modulation to phase modulation under specified conditions.

5.16.2 Circuit diagram

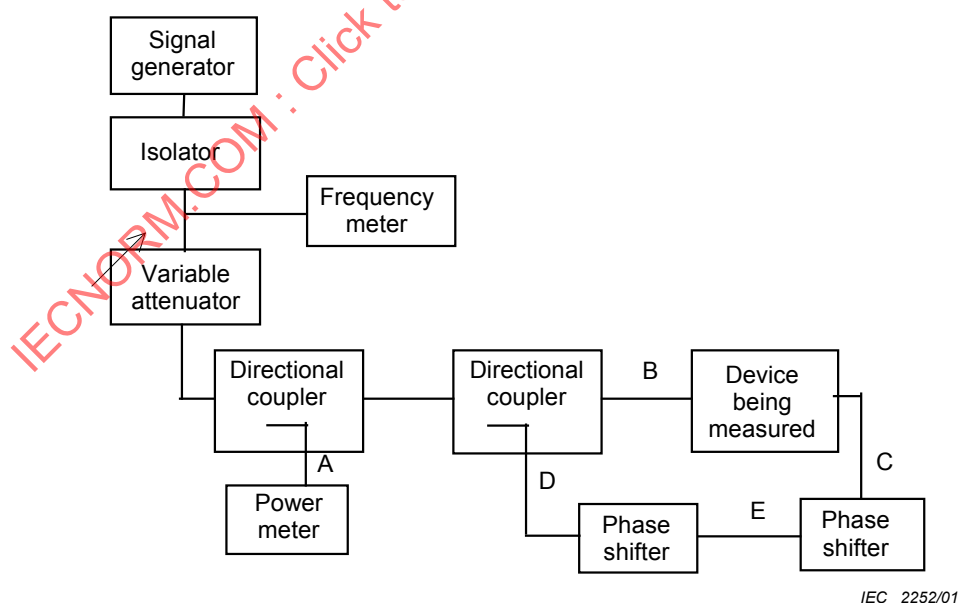


Figure 7 – Basic circuit for the measurement of $\alpha_{(AM-PM)}$

NOTE A network analyser can also be used to measure the conversion coefficient of amplitude modulation to phase modulation.

5.16.3 Principle of measurement

In the circuit diagram shown in figure 7, the input power P_i is derived from the following equation:

$$P_i = P_1 + L_1 \quad (21)$$

where

P_1 is the value indicated by the power meter;

L_1 is the circuit loss from point A to point B shown in figure 7.

The output signal-phase ϕ_0 in the circuit diagram is derived from the following equation:

$$\phi_0 = \phi_1 - \phi_2 \quad (22)$$

where

ϕ_1 , ϕ_2 are the phase differences from point B to point C and from point D to point E shown in figure 7 at the specified input power P_i , respectively.

P_i , P_1 are expressed in dBm. L_1 is expressed in decibels. ϕ_0 , ϕ_1 , and ϕ_2 are expressed in degrees.

The conversion coefficient of amplitude modulation to phase modulation is derived from equations (21) and (22) as follows:

$$\alpha_{(AM-PM)} = \Delta\phi_0 / \Delta P_1 \quad (23)$$

where

ΔP_1 is the input power change according to the modulation of variable attenuator;

$\Delta\phi_0$ is the signal-phase deviation corresponding to the change of input power.

5.16.4 Circuit description and requirements

See the circuit description and requirements of 5.2.4.

It is better that the through-circuitry signal phase is measured beforehand and the phase shifter shown in figure 7 adjusted to $\phi_0 = 0$ for the convenience of the deviation calculation, before installing the device being measured.

5.16.5 Precautions to be observed

See the precautions to be observed in 5.2.5.

Harmonics or spurious responses of the signal generator and the device being measured should be reduced to a negligible level.

5.16.6 Measurement procedure

The frequency of the signal generator should be adjusted to the specified value.

The bias under specified conditions is applied.

A specified input power is applied to the device being measured.

Measure the signal-phase ϕ_1 and ϕ_2 , then calculate ϕ_0 according to the equation (22).

By increasing input power, measure and calculate another ϕ_1 , ϕ_2 , and ϕ_0 .

Conversion coefficient: $\alpha_{(AM-PM)}$ is determined from the equation (23) at the specified input power.

5.16.7 Specified conditions

- Ambient or reference-point temperature
- Bias conditions
- Input power
- Frequency
- Increment of input power

5.17 Group delay time ($t_{d(grp)}$)

5.17.1 Purpose

To measure the group delay time under specified conditions.

5.17.2 Circuit diagram

See the circuit diagram shown in figure 7.

NOTE A network analyser can also be used to measure the group delay time.

5.17.3 Principle of measurement

In the circuit diagram shown in figure 7, the output signal-phase ϕ_0 is derived from the following equation:

$$\phi_0 = \phi_1 - \phi_2 \quad (24)$$

where

ϕ_1 , ϕ_2 are the phase differences from point B to point C and from point D to point E at the specified input signal angular frequency ω , respectively;

ϕ_0 , ϕ_1 and ϕ_2 are expressed in radians;

ω is expressed in radians/second.

The group delay time is derived from equation (24) as follows:

$$t_{d(grp)} = -\Delta\phi_0/\Delta\omega \quad (25)$$

where

$\Delta\omega$ is the change of input signal angular frequency;

$\Delta\phi_0$ is the signal-phase deviation corresponding to the change of input frequency.

5.17.4 Circuit description and requirements

See the circuit description and requirements in 5.2.4.

The through-circuitry signal phase should be measured beforehand and the phase shifter shown in figure 7 adjusted to $\phi_0 = 0$ before installing the device being measured.

5.17.5 Precautions to be observed

See the precautions to be observed in 5.16.5.

5.17.6 Measurement procedure

The frequency of the signal generator should be adjusted to the specified value.

The bias under specified conditions is applied.

A specified input power is applied to the device being measured.

Measure the signal-phase ϕ_1 and ϕ_2 , then calculate ϕ_0 according to equation (24).

By increasing input frequency, measure and calculate another ϕ_1 , ϕ_2 , and ϕ_0 .

Group delay time: $t_{d(\text{grp})}$ is determined from the equation (25) at the specified input angular frequency.

5.17.7 Specified conditions

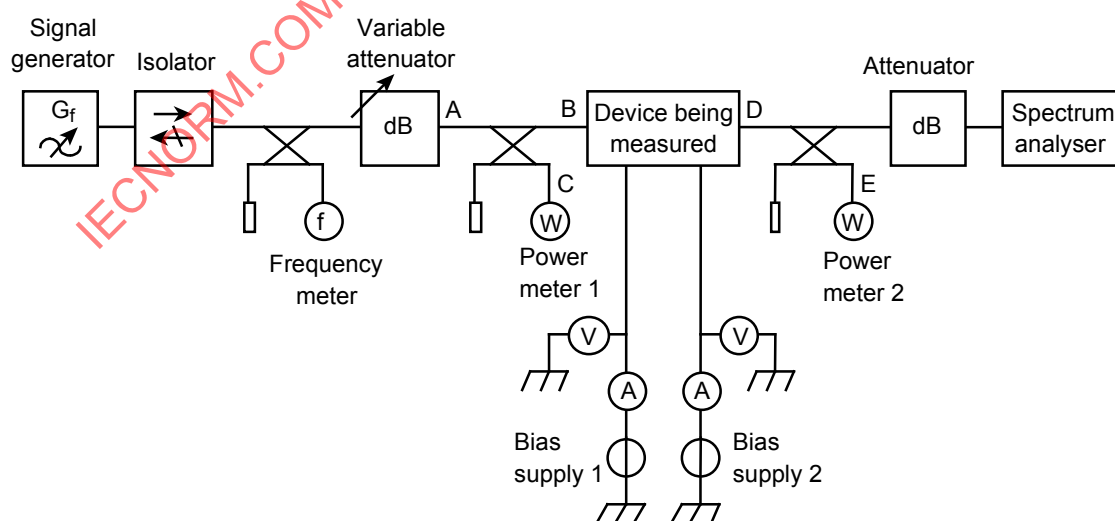
- Ambient or reference-point temperature
- Bias conditions
- Input power
- Frequency
- Increment of input frequency

5.18 Power added efficiency

5.18.1 Purpose

To measure the power added efficiency under specified conditions.

5.18.2 Circuit diagram



IEC 2253/01

Figure 8 – Circuit for the measurement of the power added efficiency

5.18.3 Principle of measurement

In the circuit diagram shown in figure 8, input power P_i and output power P_o in dBm are derived from equations:

$$P_i = P_1 - L_1 \quad (26)$$

$$P_o = P_2 + L_2 \quad (27)$$

where

P_1 is the value indicated by the power meter 1, in dBm;

P_2 is the value indicated by the power meter 2, in dBm;

L_1 is the (loss from point A to point B, in dB) – (loss from point A to point C, in dB);

L_2 is the loss from point D to point E, in dB.

Power added efficiency η_{add} is derived from equation:

$$\eta_{\text{add}} = \frac{(10^{P_o/10} - 10^{P_i/10})/1000}{|V_1 \cdot I_1| + |V_2 \cdot I_2|} \quad (28)$$

where

V_1 is the d.c. voltage, in V, applied to the device by the bias supply 1;

I_1 is the d.c. current, in A, supplied to the device by the bias supply 1;

V_2 is the control d.c. voltage, in V, applied to the device by the bias supply 2;

I_2 is the control d.c. current, in A, supplied to the device by the bias supply 2.

NOTE 1 Power added efficiency is normally expressed as a percentage; i.e. $100 \times \eta_{\text{add}}$ from the equation (28).

NOTE 2 Sometimes P_i is neglected in the equation (28) because it is usually much smaller than P_o .

5.18.4 Circuit description and requirements

Bias supply 2 is for the gain control of the device being measured. L_1 and L_2 should be measured beforehand.

5.18.5 Precautions to be observed

The output signal and oscillation should be checked by spectrum analyser. Oscillation should be eliminated during these measurements. Harmonics or spurious responses of the signal generator should be reduced to be negligible.

5.18.6 Measurement procedure

The frequency of the signal generator is adjusted to the specified value.

The bias under specified conditions are applied.

Output power P_o is set to the specified value by adjusting V_2 , I_2 or input power P_i .

DC bias currents and voltages are measured.

The power added efficiency η_{add} is calculated from equation (28).

5.18.7 Specified conditions

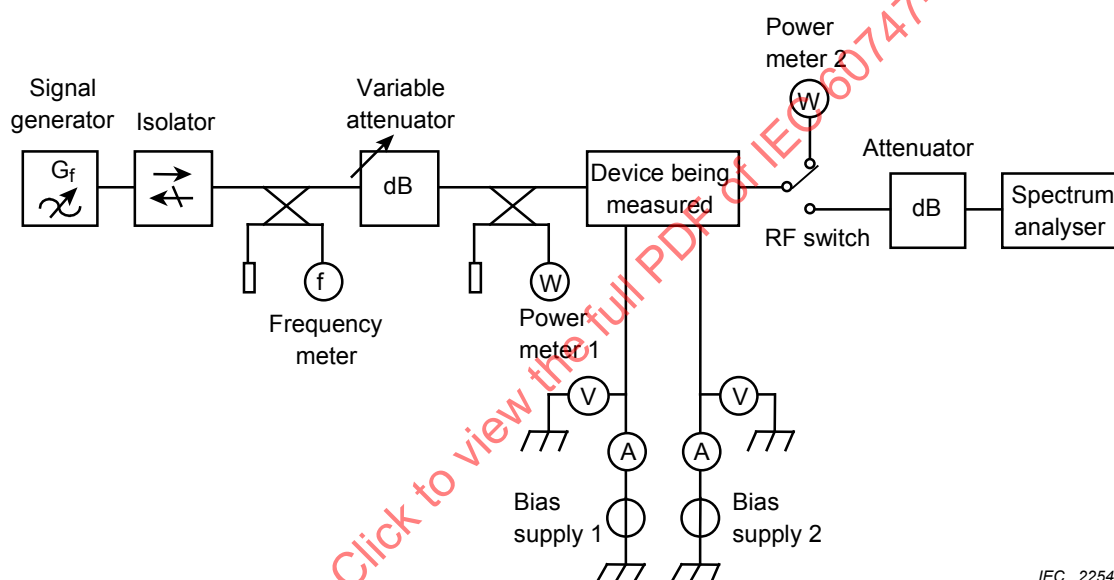
- Ambient or reference-point temperature
- Bias conditions
- Frequency
- Output power

5.19 n th order harmonic distortion ratio (P_{nth}/P_1)

5.19.1 Purpose

To measure the n th order harmonic distortion ratio P_{nth}/P_1 under specified conditions.

5.19.2 Circuit diagram



IEC 2254/01

Figure 9 – Circuit for the measurements of the n th order harmonic distortion ratio

5.19.3 Principle of measurement

In the circuit diagram shown in figure 9, n th order harmonic distortion ratio P_{nth}/P_1 are derived from equation

$$P_{nth}/P_1 = P_{nth} - P_1 \text{ (dBc)} \quad (29)$$

where

- P_1 is the power of the fundamental frequency measured by the spectrum analyser in dBm;
- P_{nth} is the power of the n th order harmonic component measured by the spectrum analyser in dBm.

5.19.4 Circuit description and requirements

Bias supply 2 is for the gain control of the device being measured.

5.19.5 Precautions to be observed

The output signal and oscillation should be checked by spectrum analyser.

Oscillation should be eliminated during these measurements.

Harmonics or spurious responses of the signal generator should be reduced to be negligible.

5.19.6 Measurement procedure

The frequency of the signal generator is adjusted to the specified value.

The bias V_1 or I_1 under specified conditions is applied.

Output power P_o is set to the specified value by adjusting V_2 , I_2 or input power P_i .

The power of the fundamental frequency P_1 and the power of the n th order harmonic component P_{nth} are measured by spectrum analyser.

The n th order harmonic distortion ratio P_{nth}/P_1 is calculated from equation (29).

5.19.7 Specified conditions

- Ambient or reference-point temperature
- Bias conditions
- Frequency (fundamental)
- Input power
- Output power

5.20 Output noise power (P_N)

5.20.1 Purpose

To measure the output noise power under specified conditions.

5.20.2 Circuit diagram

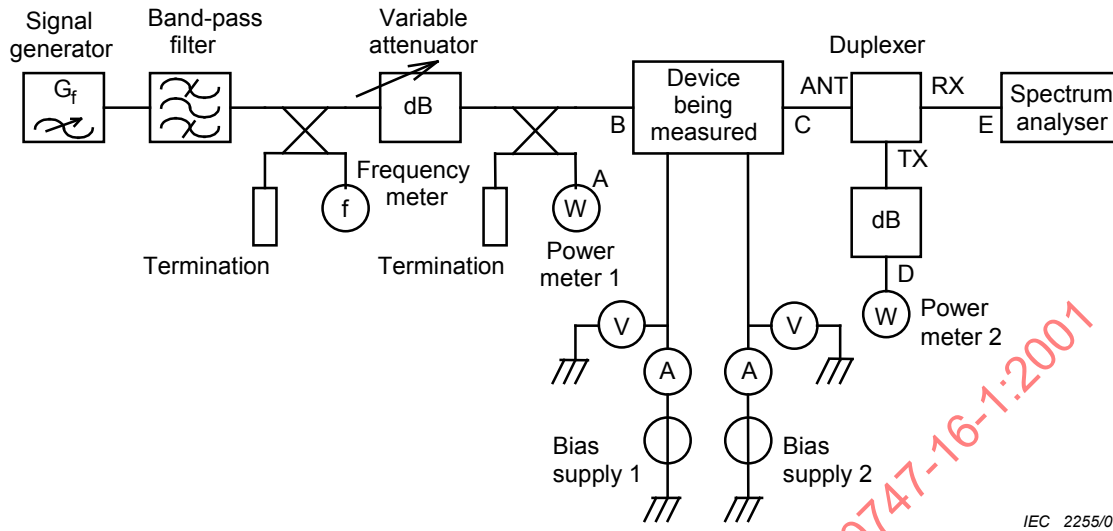


Figure 10 – Circuit diagram for the measurement of the output noise power

5.20.3 Principle of measurement

Output noise power P_N is the maximum output noise power delivered from the device being measured within the specified frequency range of noise measurement under the condition that the specified input power of the specified frequency P_i is applied and specified output power P_o is derived.

In the circuit diagram shown in figure 10 P_i , P_o , and P_N are obtained by following equations:

$$P_i = P_1 - L_1 \quad (30)$$

$$P_o = P_2 - L_2 \quad (31)$$

$$P_N = P_3 - L_3 \quad (32)$$

where

P_1 is the value indicated by power meter 1, in dBm;

P_2 is the value indicated by power meter 2, in dBm;

P_3 is the maximum value measured by the spectrum analyser in the specified frequency range for noise power measurement;

L_1 is (the power at point A, in dBm) – (the power at point B, in dBm) for the fundamental frequency;

L_2 is (the power at point C, in dBm) – (the power at point D, in dBm) for the fundamental frequency;

L_3 is (the power at point C, in dBm) – (the power at point E, in dBm) for the noise power measurement frequency.

5.20.4 Circuit description and requirements

The pass band of band-pass filter is the fundamental frequency band (the frequency band for transmission) and the stop band is the noise power measurement frequency (the frequency band for reception). It should be inserted to reduce the noise from the signal generator.

ANT-TX path of duplexer passes the fundamental frequency signal and stops the noise power measurement frequency signal, and ANT-RX path passes the noise power measurement frequency signal and stops the fundamental frequency signal. The purpose of the duplexer is to prevent the spectrum analyser from saturation by the fundamental frequency signal.

Bias supply 2 is for gain control of the device being measured.

L_1 , L_2 , and L_3 should be measured beforehand.

5.20.5 Precautions to be observed

Oscillation should be eliminated during the measurement. Harmonics and spurious response of the signal generator should be reduced to negligible.

In order to enhance the sensitivity of the spectrum analyser, if necessary, the amplifier is inserted between the duplexer and the spectrum analyser. The noise from the inserted amplifier should be negligibly small.

5.20.6 Measurement procedure

The frequency of the signal generator is adjusted to the specified value.

The biases under specified conditions are applied.

Output power P_o is set to the specified value by adjusting V_2 , I_2 or input power P_i .

The maximum power in the specified noise measurement frequency band is measured by the spectrum analyser.

The noise power P_N is calculated from equation (32)

5.20.7 Specified conditions

- Ambient or reference point temperature
- Bias conditions
- Fundamental frequency
- Frequency band of noise measurement
- Input power
- Output power

5.21 Spurious intensity under specified load VSWR (P_{sp}/P_o)

5.21.1 Purpose

To measure the spurious intensity under specified load VSWR to determine the stability under specified conditions.

5.21.2 Circuit diagram

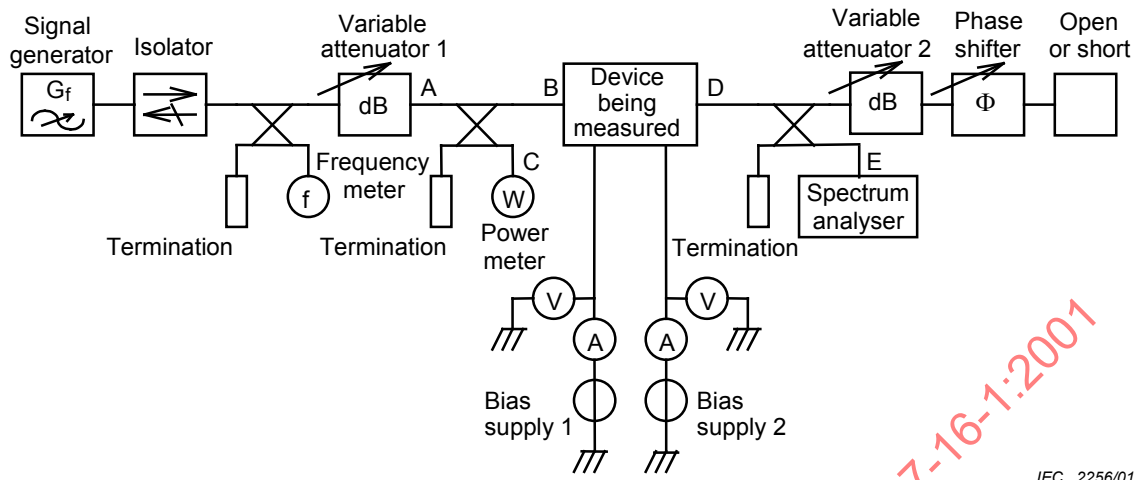


Figure 11 – Circuit diagram for the measurement of the spurious intensity

5.21.3 Principle of measurement

In the circuit diagram shown in figure 11, the output power P_o and the spurious output power P_{sp} are derived as follows:

$$P_o = P_1 - L_1 \quad (33)$$

$$P_{sp} = P_2 - L_2 \quad (34)$$

where P_1 is the value of the fundamental output indicated by the spectrum analyser in dBm, P_2 the value of the spurious output of the maximum power, except harmonic components, indicated by the spectrum analyser in dBm, and L_1 and L_2 are the circuit losses from point D to point E, in dB, at the frequency of P_1 , at the frequency of P_2 , respectively.

The spurious intensity P_{sp}/P_o in dBm is defined as follows:

$$P_{sp}/P_o = P_{sp} - P_o \quad (35)$$

5.21.4 Circuit description and requirements

Bias supply 2 is for gain control of the device being measured.

The variable attenuator 2 should be adjusted to get the specified load VSWR at point D beforehand.

L_1 and L_2 should be measured beforehand.

5.21.5 Precautions to be observed

Harmonics or spurious responses of the signal generator should be reduced to be negligible.

Oscillation will occur at the out-of-band frequency of the directional coupler.

5.21.6 Measurement procedure

The frequency of the signal generator is adjusted to the specified value.

The bias under specified conditions is applied.

The specified input power is applied.

By varying the phase of the phase shifter through the specified phase range, find the maximum spurious output.

While keeping the phase, measure the power of the fundamental frequency P_1 and the power of the spurious output P_{sp} with the spectrum analyser.

The spurious intensity P_{sp}/P_o is calculated from equation (35).

5.21.7 Specified conditions

- Ambient or reference point temperature
 - Bias conditions
 - Input frequency
 - Input power
 - Load VSWR
 - Phase variation range of load
-

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	48
1 Domaine d'application	49
2 Références normatives	49
3 Terminologie	49
4 Valeurs assignées et caractéristiques essentielles	52
4.1 Généralités	52
4.2 Description relative à l'application	52
4.3 Spécification de la fonction	53
4.4 Valeurs limites (système de valeurs assignées maximales absolues)	55
4.5 Conditions de fonctionnement (dans la plage de température de fonctionnement spécifiée)	56
4.6 Caractéristiques électriques	57
4.7 Valeurs assignées mécaniques et environnementales, caractéristiques et données	59
4.8 Informations supplémentaires	59
5 Méthodes de mesure	60
5.1 Généralités	60
5.2 Gain (en puissance) linéaire (G_{lin})	60
5.3 Uniformité du gain (en puissance) linéaire (ΔG_{lin})	62
5.4 Gain en puissance (G_p)	63
5.5 Uniformité du gain (en puissance) (ΔG_p)	64
5.6 Réduction du gain (maximum disponible) (ΔG_{red})	65
5.7 Puissance de sortie limite ($P_{o(ltg)}$)	66
5.8 Puissance de sortie (P_o)	67
5.9 Puissance de sortie pour une compression de gain de 1 dB ($P_{o(1dB)}$)	67
5.10 Facteur de bruit (F)	68
5.11 Distorsion d'intermodulation (à deux tonalités) (P_n/P_1)	70
5.12 Puissance au point d'interception (pour les produits d'intermodulation) ($P_{n(IP)}$)	72
5.13 Amplitude du coefficient de réflexion d'entrée (affaiblissement de réflexion d'entrée) ($ s_{11} $)	73
5.14 Amplitude du coefficient de réflexion de sortie (affaiblissement de réflexion de sortie) ($ s_{22} $)	75
5.15 Amplitude du coefficient de transmission inverse (isolation) ($ s_{12} $)	78
5.16 Coefficient de conversion modulation d'amplitude/modulation de phase ($\alpha(AM-PM)$)	80
5.17 Temps de retard de groupe ($t_{d(grp)}$)	81
5.18 Rendement en puissance ajoutée	83
5.19 Taux de distorsion de l'harmonique de rang n (P_n/P_1)	84
5.20 Puissance de bruit en sortie (P_N)	86
5.21 Intensité parasite selon le ROS de charge spécifiée (P_{sp}/P_o)	88
Figure 1 – Circuit pour les mesures du gain linéaire	61
Figure 2 – Circuit de base pour la mesure du facteur de bruit	69

Figure 3 – Circuit de base pour les mesures de la distorsion d'intermodulation à deux fréquences porteuses	71
Figure 4 – Circuit pour les mesures d'amplitude du coefficient de réflexion d'entrée/ de sortie (affaiblissement de réflexion d'entrée/de sortie)	74
Figure 5 – Circuit pour la mesure du coefficient de réflexion de sortie.....	77
Figure 6 – Circuit pour la mesure de l'isolation	79
Figure 7 – Circuit de base pour la mesure de $\alpha_{(AM-PM)}$	80
Figure 8 – Circuit pour la mesure du rendement en puissance ajoutée.....	83
Figure 9 – Circuit pour les mesures du taux de distorsion de l'harmonique de rang n	85
Figure 10 – Schéma du circuit de mesure de la puissance de bruit en sortie.....	86
Figure 11 – Schéma de circuit pour la mesure de l'intensité parasite	88

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60747-16-1:2001

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS –

Partie 16-1: Circuits intégrés hyperfréquences – Amplificateurs

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI n'a prévu aucune procédure de marquage valant indication d'approbation et n'engage pas sa responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme Internationale CEI 60747-16-1 a été établie par le sous-comité 47E: Dispositifs à semiconducteurs discrets, du comité d'études 47 de la CEI: Dispositifs à semiconducteurs.

La présente version bilingue (2012-09) correspond à la version anglaise monolingue publiée en 2001-11.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 47E/200/FDIS et 47E/204/RVD.

Le rapport de vote 47E/204/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

La version française de cette norme n'a pas été soumise au vote.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication restait valable jusqu'en 2004. A cette date, la publication sera:

- reconduite;
- annulée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS –

Partie 16-1: Circuits intégrés hyperfréquences – Amplificateurs

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 60747 fournit la terminologie, les valeurs assignées et caractéristiques essentielles, ainsi que les méthodes de mesure pour des amplificateurs de puissance hyperfréquences à circuits intégrés.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la Norme internationale CEI 60747. Pour les références datées, tout amendement ou toute révision portant sur ces publications qui seraient publiés ultérieurement ne s'applique pas. Cependant, les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la CEI 60747 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Pour les références non datées, la dernière édition du document normatif en référence s'applique. Les membres de la CEI et de l'ISO tiennent à jour l'état des normes internationales en vigueur.

CEI 60617-12:1997, *Symboles graphiques pour schémas – Partie 12: Opérateurs logiques binaires*

CEI 60617-13:1993, *Symboles graphiques pour schémas – Partie 13: Eléments analogues*

CEI 60747-1:1983, *Dispositifs à semiconducteurs – Partie 1: Généralités*

CEI 60747-7:2000, *Dispositifs à semiconducteurs – Partie 7: Transistors bipolaires*

CEI 60748-2:1997, *Dispositifs à semiconducteurs – Circuits intégrés – Partie 2: Circuits intégrés numériques*

CEI 60748-3:1986, *Dispositifs à semiconducteurs – Circuits intégrés – Partie 3: Circuits intégrés analogiques*

CEI 60748-4:1997, *Dispositifs à semiconducteurs – Circuits intégrés – Partie 4: Circuits intégrés d'interface*

3 Terminologie

3.1

gain (en puissance) linéaire G_{lin}

gain en puissance dans la région linéaire de la courbe de transfert de puissance P_o (dBm) = $f(P_i)$

NOTE Dans cette région, ΔP_o (dBm) = ΔP_i (dBm).

3.2

uniformité du gain (en puissance) linéaire ΔG_{lin}

uniformité du gain en puissance lorsque le point de fonctionnement se trouve dans la région linéaire de la courbe de transfert de puissance

3.3

gain en puissance G_p , G

rapport de la puissance de sortie sur la puissance d'entrée

NOTE Habituellement le gain en puissance est exprimé en décibels.

3.4

uniformité du gain (en puissance) ΔG_p

différence entre le gain en puissance maximale et minimale pour une puissance d'entrée spécifiée dans une plage de fréquences spécifiée

3.5

réduction du gain (maximum disponible) ΔG_{red}

différence en décibels entre les gains en puissance maximale et minimale pouvant être fournis par la commande de gain

3.6 Limitation de puissance de sortie

3.6.1

plage limite de puissance de sortie

plage dans laquelle la puissance de sortie est limitée pour augmenter la puissance d'entrée

NOTE Pour les spécifications, les limites de cette plage sont indiquées par des valeurs limites inférieure et supérieure pour la puissance d'entrée.

3.6.2

puissance de sortie limite $P_{o(ltg)}$

puissance de sortie dans la plage dans laquelle elle est limitée

3.6.3

uniformité de la puissance de sortie limite $\Delta P_{o(ltg)}$

différence entre la puissance de sortie maximale et minimale dans la plage limite de puissance de sortie:

$$\Delta P_{o(ltg)} = P_{o(ltg,max)} - P_{o(ltg,min)}$$

3.7

distorsion d'intermodulation P_n/P_i

rapport

de la composante du $n^{\text{ième}}$ ordre de la puissance de sortie sur

la composante fondamentale de la puissance de sortie

à une puissance d'entrée spécifiée

3.8

puissance au point interception (pour les produits d'intermodulation), $P_{n(IP)}$

la puissance de sortie à l'intersection entre les puissances de sortie extrapolées de la composante fondamentale et des composantes d'intermodulation du $n^{\text{ième}}$ ordre, lorsque l'extrapolation est effectuée dans un diagramme représentant la puissance de sortie des composants (en décibels) en fonction de la puissance d'entrée (en décibels)

3.9**amplitude du coefficient de réflexion d'entrée**

(affaiblissement de réflexion d'entrée)

 $|s_{11}|$

voir 3.5.2.1 de la CEI 60747-7

3.10**amplitude du coefficient de réflexion de sortie**

(affaiblissement de réflexion de sortie)

 $|s_{22}|$

voir 3.5.2.2 de la CEI 60747-7

3.11**amplitude du coefficient de transmission inverse**

(isolation)

 $|s_{12}|$

voir 3.5.2.4 de la CEI 60747-7

3.12**coefficient de conversion modulation d'amplitude/modulation de phase $\alpha_{(AM-PM)}$**

quotient de

la déviation de phase du signal de sortie (en degrés) par
la variation de puissance d'entrée (en décibels) le produisant

3.13**temps de retard de groupe $t_{d(grp)}$**

rapport, en fonction de la fréquence angulaire, de la variation du déphasage par
l'intermédiaire de l'amplificateur

NOTE Habituellement, le temps de retard de groupe est très proche en valeur du temps de retard entrée/sortie.

3.14**taux de distorsion de l'harmonique de rang n P_{nth}/P_1**

rapport de la puissance de la composante harmonique de rang n mesurée au port de sortie
sur la puissance de la fréquence fondamentale mesurée au port de sortie du dispositif pour
une puissance de sortie donnée

3.15**puissance de bruit en sortie P_N**

puissance de bruit maximale mesurée au port de sortie du dispositif selon une largeur de
bande comprise dans une plage de fréquences spécifiée pour une sortie de puissance
donnée

3.16**intensité parasite selon le ROS (rapport d'ondes stationnaires) de charge spécifiée** P_{sp}/P_o

rapport de la puissance parasite maximale mesurée au port de sortie sur la puissance de la
fréquence fondamentale mesurée au port de sortie du dispositif selon le ROS de charge
spécifiée

4 Valeurs assignées et caractéristiques essentielles

4.1 Généralités

4.1.1 Identification et types de circuits

4.1.1.1 Désignation et types

Il convient de préciser l'indication du type (nom du dispositif), la catégorie du circuit et la technologie appliquée.

Les amplificateurs hyperfréquences sont divisés en quatre catégories:

Type A: à faible bruit.

Type B: à commande automatique de gain.

Type C: limiteur.

Type D: de puissance.

4.1.1.2 Description de la fonction générale

Il convient d'effectuer une description générale de la fonction exécutée par les amplificateurs hyperfréquences à circuits intégrés et des caractéristiques relatives à l'application.

4.1.1.3 Technologie de fabrication

Il convient de mentionner la technologie de fabrication, par exemple, un circuit intégré monolithique à semiconducteurs, un circuit intégré à couches minces, un micro-assemblage. Il convient d'y inclure des détails relatifs aux technologies des semiconducteurs, comme le MESFET, le MISFET, le transistor bipolaire au silicium, le HBT (transistor bipolaire à hétérojonction), etc.

4.1.1.4 Identification du boîtier

Il convient d'indiquer ce qui suit:

- a) numéro CEI ou de référence nationale du dessin d'encombrement, ou dessin de boîtier non normalisé comprenant une numérotation des bornes;
- b) matériau principal du boîtier; par exemple : métal, céramique, plastique.

4.1.1.5 Application principale

Il convient de mentionner, si nécessaire, l'application principale. Si le dispositif présente des applications restrictives, il convient de le mentionner ici.

4.2 Description relative à l'application

Il convient de donner des informations sur l'application du circuit intégré et sur sa relation avec les dispositifs associés.

4.2.1 Conformité au système et/ou aux informations d'interface

Il convient de mentionner si le circuit intégré est conforme à un système d'application et/ou une norme ou des recommandations d'interface.

Il convient également de donner des informations détaillées concernant les systèmes d'application, équipements et circuits, tels que les réseaux VSAT, les récepteurs satellites de radiodiffusion directe, les systèmes d'atterrissage hyperfréquences, etc.

4.2.2 Schéma de principe global

Il convient, si nécessaire, de fournir un schéma de principe des systèmes appliqués.

4.2.3 Données de référence

Il convient d'indiquer les propriétés les plus importantes pour permettre une comparaison entre des types de dérivée.

4.2.4 Compatibilité électrique

Il convient de mentionner si le circuit intégré est compatible du point de vue électrique avec d'autres circuits intégrés particuliers ou familles de circuits intégrés ou si des interfaces spéciales sont nécessaires.

Il convient de fournir des détails concernant le type de circuits d'entrée et de sortie, par exemple, impédances d'entrée/de sortie, blocage du courant continu, drain ouvert, etc. Il convient de mentionner, le cas échéant, l'interchangeabilité avec d'autres dispositifs.

4.2.5 Dispositifs associés

Il convient, le cas échéant, de mentionner ici ce qui suit:

- dispositifs nécessaires pour un fonctionnement correct (liste indiquant le numéro du type, le nom et la fonction);
- dispositifs périphériques avec interconnexion directe (liste indiquant le numéro du type, le nom et la fonction).

4.3 Spécification de la fonction

4.3.1 Schéma de principe détaillé – Blocs fonctionnels

Il convient de fournir un schéma de principe détaillé ou des informations de circuit équivalentes relatives aux amplificateurs hyperfréquences à circuits intégrés. Dans le schéma de principe, il convient d'indiquer ce qui suit:

- 1) blocs fonctionnels;
- 2) interconnexions mutuelles entre les blocs fonctionnels;
- 3) unités fonctionnelles individuelles parmi les blocs fonctionnels;
- 4) interconnexions mutuelles entre les blocs fonctionnels individuels;
- 5) fonction de chaque connexion externe;
- 6) interdépendance entre les blocs fonctionnels séparés.

Il convient d'identifier, dans le schéma de principe, la fonction de chaque connexion externe et, lorsque aucune ambiguïté n'est possible, les symboles et/ou numéros des bornes. Si l'encapsulation présente des parties métalliques, il convient d'indiquer toute connexion de bornes externes à ces dernières. Lorsque cela s'avère nécessaire, il convient de mentionner les connexions avec tous les éléments électriques externes associés.

A titre d'informations supplémentaires, le schéma des circuits électriques peut être reproduit, mais pas nécessairement avec les indications de valeurs des composants de circuit. Le symbole graphique pour la fonction doit être indiqué. Celui-ci peut être obtenu dans un catalogue de normes des symboles graphiques ou conçu selon les règles de la CEI 60617-12 ou CEI 60617-13.

4.3.2 Identification et fonction des bornes

Il convient d'identifier toutes les bornes sur le schéma de principe (bornes d'alimentation, bornes d'entrée ou de sortie, bornes d'entrée/de sortie).

Il convient d'indiquer les fonctions des bornes 1)-4) dans un tableau comme suit:

Numéro de la borne	Symbole de la borne	1) Désignation de la borne	2) Fonction	Fonction de la borne	
				3) Identification d'entrée/de sortie	4) Type de circuit d'entrée/de sortie

1) Nom de la borne

Il convient de mentionner un nom de borne pour indiquer sa fonction. Il convient de différencier les bornes d'alimentation, les bornes de terre, les bornes non connectées (avec l'abréviation NC), et les bornes non utilisables (avec l'abréviation NU).

2) Fonction

Il convient d'indiquer brièvement la fonction des bornes.

- Chaque fonction de bornes polyvalentes, c'est-à-dire les bornes qui ont des fonctions multiples.
- Chaque fonction du circuit intégrée sélectionnée par des connexions de broches mutuelles, la programmation et/ou l'application de données de sélection de fonction sur la broche de sélection de fonction, telle qu'une broche de sélection de mode.

3) Identification d'entrée/de sortie

Il convient de différencier les bornes d'entrée, de sortie, d'entrée/de sortie, et d'entrée/de sortie de multiplexage.

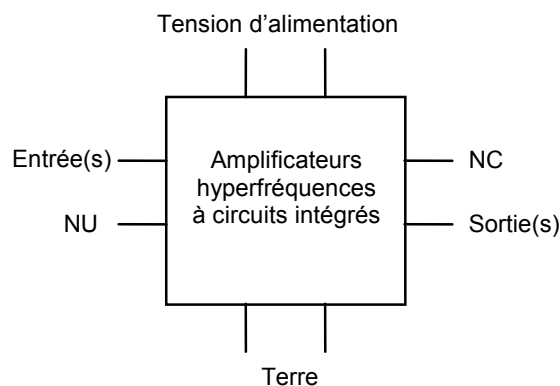
4) Type de circuits d'entrée/de sortie

Il convient de différencier les types de circuits d'entrée et de sortie, par exemple, les impédances d'entrée/de sortie avec ou sans blocage du courant continu, etc.

5) Type de mise à la terre

Si la plaque de base du boîtier est utilisée comme mise à la terre, il convient de le mentionner.

Exemple:



4.3.3 Description fonctionnelle

Il convient de préciser la fonction réalisée par le circuit, comprenant les informations suivantes:

- fonction de base;
- relation avec les bornes externes;

- mode de fonctionnement (par exemple, méthode de réglage, préférence, etc.);
- traitement d'interruption.

4.3.4 Caractéristiques relatives à la famille

Dans cette partie, toutes les descriptions fonctionnelles caractéristiques de la famille doivent être mentionnées (voir la CEI 60748-2, la CEI 60748-3 et la CEI 60748-4).

S'il existe des valeurs assignées et caractéristiques, ainsi que des caractéristiques fonctionnelles pour la famille, il convient d'utiliser la partie concernée de la CEI 60748 (par exemple, pour les microprocesseurs, voir la CEI 60748-2, chapitre III, section 3).

NOTE Pour chaque nouvelle famille de dispositif, des éléments spécifiques doivent être ajoutés dans la partie concernée de la CEI 60748.

4.4 Valeurs limites (système de valeurs assignées maximales absolues)

Le tableau de ces valeurs contient les indications suivantes.

- Toute interdépendance des conditions de limitation doit être spécifiée.
- Si des éléments attachés et/ou connectés en externe, par exemple des dissipateurs thermiques, ont une influence sur les valeurs assignées, celles-ci doivent être prescrites pour le circuit intégré avec les éléments connectés et/ou attachés.
- Si des valeurs limites sont dépassées pour la surcharge transitoire, l'excès autorisé et sa durée doivent être spécifiés.
- Lorsque les valeurs minimale et maximale diffèrent pendant la programmation du dispositif, il convient de le mentionner.
- Toutes les tensions font référence à une borne de référence spécifiée (V_{SS} , G_{ND} , etc.).
- Concernant les articles suivants, si les valeurs maximales et/ou minimales sont citées, le fabricant doit indiquer s'il fait référence à l'amplitude absolue ou à la valeur algébrique de la quantité.
- Les valeurs assignées doivent couvrir le fonctionnement du circuit intégré multifonction sur la plage spécifique de températures de fonctionnement. Lorsque les valeurs assignées sont fonction de la température, il convient de l'indiquer.

4.4.1 Valeurs limites électriques

Il convient d'indiquer les valeurs limites comme suit:

	Paramètres	Minimum	Maximum
(1)	Tensions d'alimentation	+	+
(2)	Courants d'alimentation (s'il y a lieu)		+
(3)	Tension(s) d'entrée (s'il y a lieu)	+	+
(4)	Tension(s) de sortie (s'il y a lieu)	+	+
(5)	Courant(s) d'entrée (s'il y a lieu)		+
(6)	Courant(s) de sortie (s'il y a lieu)		+
(7)	Autre(s) tension(s) de borne (s'il y a lieu)	+	+
(8)	Autre(s) courant(s) de borne (s'il y a lieu)		+
(9)	Différence de tension entre l'entrée et la sortie (s'il y a lieu)	+	+
(10)	Dissipation de puissance		+

Les spécifications détaillées peuvent indiquer ces valeurs dans le tableau comprenant la note 1 et la note 2.

Paramètres (Note 1, Note 2)	Symboles	Minimum	Maximum	Unité
NOTE 1 S'il y a lieu, selon le type de circuit considéré. NOTE 2 Pour une plage de tension d'alimentation: – valeur(s) limite(s) de la (des) tension(s) à la (aux) borne(s) d'alimentation par rapport à un point de référence électrique spécial; – le cas échéant, valeur limite entre des bornes d'alimentation spécifiées; – lorsque plus d'une source d'alimentation est nécessaire, il convient de mentionner si l'ordre dans lequel ces sources sont appliquées est significatif; si c'est le cas, il convient de mentionner cet ordre; – lorsque plus d'une source est requise, il peut être nécessaire de mentionner les combinaisons de valeurs assignées pour ces tensions d'alimentation et courants.				

4.4.2 Températures

- 1) Température de fonctionnement
- 2) Température de stockage
- 3) Température du canal (type C et type D uniquement)
- 4) Température maximale de broche de raccordement (pour le soudage).

Les spécifications détaillées peuvent indiquer ces valeurs dans le tableau comprenant la note.

Paramètres (Note)	Symboles	Minimum	Maximum	Unité
NOTE S'il y a lieu, selon le type de circuit considéré.				

4.5 Conditions de fonctionnement (dans la plage de températures de fonctionnement spécifiée)

Elles ne doivent pas être inspectées mais peuvent être utilisées pour une évaluation de la qualité.

4.5.1 Valeurs positives et/ou négatives de sources d'alimentation

4.5.2 Séquences d'initialisation (s'il y a lieu)

Si des séquences d'initialisation sont nécessaires, il convient de spécifier le séquençement des sources d'alimentation et la procédure d'initialisation.

4.5.3 Tension(s) d'entrée (s'il y a lieu)**4.5.4 Courant(s) de sortie (s'il y a lieu)****4.5.5 Tension et/ou courant d'autre(s) borne(s)****4.5.6 Éléments externes (s'il y a lieu)****4.5.7 Plage de températures de fonctionnement****4.6 Caractéristiques électriques**

Les caractéristiques doivent s'appliquer sur toute la plage de températures de fonctionnement, sauf mention contraire.

Chaque caractéristique de 4.6.1 et 4.6.2 doit être mentionnée

- a) sur la plage spécifiée de températures de fonctionnement, ou
- b) à une température de 25 °C, et à des températures de fonctionnement maximales et minimales.

4.6.1 Caractéristiques statiques

Il convient de spécifier les paramètres en fonction du type, selon ce qui est indiqué ci-dessous.

Paramètres	Minimum	Type ^a	Maximum	Types			
				A	B	C	D
4.6.1.1 Courant d'alimentation	+	+	+	+	+	+	+
4.6.1.2 Résistance thermique			+			+	+
^a Optionnel							

Les spécifications détaillées peuvent indiquer ces valeurs dans le tableau.

Caractéristiques	Symboles	Conditions	Minimum	Type ^a	Maximum	Unité
^a Optionnel						

4.6.2 Caractéristiques dynamiques ou en courant alternatif

Il convient de mentionner chaque caractéristique dynamique ou électrique à courant alternatif dans les conditions électriques spécifiées les plus défavorables, par rapport à la plage recommandée de tensions d'alimentation, selon ce qui est mentionné en 4.5.1.

Il convient de spécifier les paramètres en fonction du type, selon ce qui est indiqué ci-dessous.

4.6.2.7	Puissance de sortie pour 1 dB de compression du gain	+				+
4.6.2.8	Puissance de sortie limite	+	+			+
4.6.2.9	Uniformité de la puissance de sortie limite		+			+
4.6.2.10	Distorsion d'intermodulation		+			+
4.6.2.11	Puissance au point d'interception	+				+
4.6.2.12	Facteur de bruit		+	+		
4.6.2.13	Amplitude du coefficient de réflexion d'entrée (affaiblissement de réflexion d'entrée)	+		+	+	+
4.6.2.14	Amplitude du coefficient de réflexion de sortie (affaiblissement de réflexion de sortie)	+		+	+	
4.6.2.15	Amplitude du coefficient de transmission inverse (isolation)	+		+	+	+
4.6.2.16	Coefficient de conversion modulation d'amplitude/modulation de phase (s'il y a lieu)		+			+
4.6.2.17	Temps de retard de groupe (s'il y a lieu)		+		+	+
4.6.2.18	Constante de temps pour la commande de gain automatique					
4.6.2.19	Rendement en puissance ajoutée (s'il y a lieu)	+				
4.6.2.20	Taux de distorsion de l'harmonique de rang n (s'il y a lieu) (note 2)		+			
4.6.2.21	Puissance de bruit en sortie (s'il y a lieu)		+			
4.6.2.22	Intensité parasite selon le ROS de charge spécifiée (s'il y a lieu) (note 2)		+			

NOTE 1 Il est nécessaire, pour les types B et D, de sélectionner soit le jeu de paramètres de 4.6.2.1, 4.6.2.2, 4.6.2.3, 4.6.2.4 et 4.6.2.6.

NOTE 2 Généralement exprimée en dBc.

^a A l'étude.

^b Optionnel. Pour le type D, il est parfois nécessaire de spécifier les dispositifs comme fonctionnant dans des conditions de fonctionnement en grands signaux au lieu d'un fonctionnement en faibles signaux. Bien

NOTE 2 Généralement exprimée en dBc.

a A l'étude.

^b Optionnel. Pour le type D, il est parfois nécessaire de spécifier les dispositifs comme fonctionnant dans des conditions de fonctionnement en grands signaux au lieu d'un fonctionnement en faibles signaux. Bien que la définition soit la même pour les deux opérations de fonctionnement, il convient d'utiliser une méthode de mesure différente pour le paramètre dans des conditions de fonctionnement en grands signaux par rapport au fonctionnement en faibles signaux.

Les spécifications détaillées peuvent indiquer ces valeurs dans le tableau.

^a Optionnel

4.7 Valeurs assignées mécaniques et environnementales, caractéristiques et données

Il convient de mentionner toutes valeurs assignées mécaniques et environnementales (voir également le chapitre VI, article 7 de la CEI 60747-1).

4.8 Informations supplémentaires

S'il y a lieu, il convient d'indiquer les informations suivantes.

4.8.1 Circuit équivalent d'entrée et de sortie

Il convient d'indiquer des informations détaillées concernant le type de circuits d'entrée et de sortie; par exemple, impédances d'entrée/de sortie, blocage du courant continu, drain ouvert; etc.

4.8.2 Protection interne

Il convient de spécifier une mention indiquant si le circuit intégré contient une protection interne contre les tensions ou les champs électriques statiques importants.

4.8.3 Condensateurs aux bornes

Si des condensateurs sont nécessaires pour le blocage du courant continu d'entrée/de sortie, il convient de mentionner ces derniers.

4.8.4 Résistance thermique

4.8.5 Interconnexions à d'autres types de circuit

S'il y a lieu, il convient de fournir des détails concernant les interconnexions à d'autres circuits, par exemple, un circuit de détection pour commande automatique de gain (CAG), des amplificateurs de détection, un amplificateur tampon.

4.8.6 Effets de composant(s) connecté(s) en externe

Des courbes ou données indiquant l'effet du (des) composant(s) connecté(s) en externe qui influencent les caractéristiques peuvent être fournies.

4.8.7 Recommandations pour tout (tous) dispositif(s) associé(s)

Par exemple, il convient de mentionner le découplage de la source d'alimentation par rapport à un dispositif haute fréquence.

4.8.8 Précautions de manipulation

S'il y a lieu, il convient de mentionner les précautions de manipulation spécifiques au circuit (voir également le Chapitre IX de la CEI 60747-1).

4.8.9 Données d'application

4.8.10 Autres informations d'application

4.8.11 Date de publication de la fiche technique

5 Méthodes de mesure

5.1 Généralités

5.1.1 Impédances caractéristiques

Les impédances caractéristiques d'entrée et de sortie du système de mesure, représentées dans le circuit de cette norme, sont de 50 Ω . Si elles ne sont pas de 50 Ω , il convient de spécifier leur valeur.

5.1.2 Précautions générales

Les précautions générales rapportées dans l'article 2 de la CEI 60747-1, chapitre VII, Section un sont applicables. De plus, il convient de veiller à utiliser les alimentations continues stabilisées, et à découpler en conséquence toutes les tensions d'alimentation de polarisation à la fréquence de mesure. Il convient également de prendre des précautions spéciales concernant l'impédance de charge du circuit d'essai, pour mesurer la puissance de sortie.

Les niveaux de puissance sont indiqués en utilisant l'unité "dBm". L'unité "dBm" exprime un décibel par rapport à 1 mW.

5.1.3 Précautions de manipulation

Lors de la manipulation de dispositifs sensibles à l'électrostatique, les précautions de manipulation indiquées dans l'Article 1 de la CEI 60747-1, Chapitre IX, doivent être observées.

5.1.4 Types

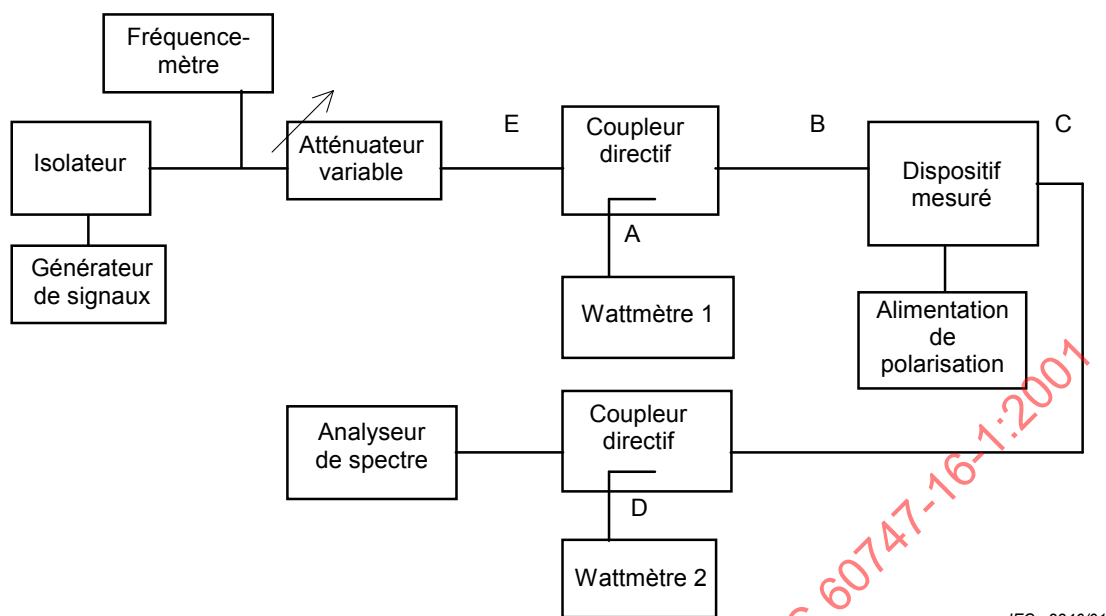
Les dispositifs de cette norme sont à la fois des dispositifs de type boîtier et puce, mesurés au moyen de supports d'essai appropriés.

5.2 Gain (en puissance) linéaire (G_{lin})

5.2.1 Objectif

Mesurer le gain linéaire dans les conditions spécifiées.

5.2.2 Schéma de circuit



IEC 2246/01

Figure 1 – Circuit pour les mesures du gain linéaire

5.2.3 Principe de mesure

Dans le schéma de la figure 1, la puissance d'entrée P_i et la puissance de sortie P_o du dispositif mesuré sont obtenues au moyen des équations suivantes:

$$P_i = P_1 + L_1 \quad (1)$$

$$P_o = P_2 + L_2 \quad (2)$$

dans lesquelles P_1 et P_2 sont les valeurs indiquées par les wattmètres 1 et 2, respectivement.

$$L_1 = L_A - L_B$$

dans lesquelles L_A est la perte du point E au point A et L_B est la perte du point E au point B, représentés respectivement sur la figure 1.

L_2 est la perte de circuit du point C au point D indiquée sur la figure 1. P_i , P_o , P_1 et P_2 sont exprimés en dBm. L_1 et L_2 sont exprimés en décibels.

Le gain en puissance G_p exprimé en dB est obtenu au moyen des équations (1) et (2) comme suit:

$$G_p = P_o - P_i \quad (3)$$

Le gain linéaire G_{lin} est le gain en puissance mesuré dans la région dans laquelle la variation de la puissance de sortie exprimée en dBm est identique à celle de la puissance d'entrée.

5.2.4 Description et exigences du circuit

L'isolateur a pour objet de permettre de maintenir constant le niveau de puissance sur le dispositif mesuré quelle que soit la désadaptation d'impédance à l'entrée.

Il convient de mesurer au préalable les pertes de circuit L_1 et L_2 .

5.2.5 Précautions à prendre

Il convient d'éliminer les oscillations relevées par l'analyseur de spectre pendant ces mesures. Les sorties doivent pouvoir supporter la puissance d'alimentation.

Il convient de réduire ces réponses parasites et harmoniques de manière à ce qu'elles deviennent négligeables.

5.2.6 Procédure de mesure

Il convient de régler la fréquence du générateur de signaux à la valeur spécifiée.

La polarisation est appliquée dans les conditions spécifiées.

Une puissance d'entrée suffisante est appliquée sur le dispositif mesuré.

En faisant varier la puissance d'entrée, confirmer que la variation de la puissance de sortie en dBm est identique à celle de la puissance d'entrée.

Le gain mesuré dans la région où la variation de la puissance de sortie est identique à celle de la puissance d'entrée est le gain linéaire G_{lin} .

5.2.7 Conditions spécifiées

- Température ambiante ou température du point de référence
- Conditions de polarisation
- Fréquence

5.3 Uniformité du gain (en puissance) linéaire (ΔG_{lin})

5.3.1 Objectif

Mesurer l'uniformité du gain linéaire dans les conditions spécifiées.

5.3.2 Schéma de circuit

Voir le schéma de circuit représenté sur la figure 1.

5.3.3 Principe de mesure

Voir le principe de mesure en 5.2.3.

Le gain en puissance linéaire est obtenu au moyen de l'équation suivante:

$$\Delta G_{lin} = G_{linmax} - G_{linmin} \quad (4)$$

dans laquelle G_{linmax} et G_{linmin} sont le gain linéaire maximal et le gain linéaire minimal dans la bande de fréquences spécifiée à la puissance d'entrée spécifiée, respectivement.

5.3.4 Description et exigences du circuit

Voir la description et les exigences du circuit en 5.2.4.

5.3.5 Précautions à prendre

Voir les précautions à prendre en 5.2.5.

5.3.6 Procédure de mesure

Il convient de régler la fréquence du générateur de signaux à la valeur spécifiée.

La polarisation est appliquée dans les conditions spécifiées.

Un niveau de puissance d'entrée suffisant est appliqué sur le dispositif mesuré.

En faisant varier le niveau de la puissance d'entrée, confirmer que la variation de la puissance de sortie en dBm est identique à celle de la puissance d'entrée.

Choisir le niveau de puissance d'entrée approprié pour mesurer le gain linéaire.

Modifier la fréquence dans la bande de fréquences spécifiée avec le même niveau de puissance d'entrée.

Obtenir le gain linéaire maximal G_{linmax} et le gain linéaire minimal G_{linmin} dans la bande de fréquences spécifiée.

L'uniformité du gain linéaire ΔG_{lin} est obtenue au moyen de l'équation (4).

5.3.7 Conditions spécifiées

- Température ambiante ou température du point de référence
- Conditions de polarisation
- Bande de fréquences

5.4 Gain en puissance (G_p)

5.4.1 Objectif

Mesurer le gain en puissance dans les conditions spécifiées.

5.4.2 Schéma de circuit

Voir le schéma de circuit représenté sur la figure 1.

5.4.3 Principe de mesure

Voir le principe de mesure en 5.2.3.

5.4.4 Description et exigences du circuit

Voir la description et les exigences du circuit en 5.2.4.

5.4.5 Précautions à prendre

Voir les précautions à prendre en 5.2.5.

5.4.6 Procédure de mesure

Il convient de régler la fréquence du générateur de signaux à la valeur spécifiée.

La polarisation est appliquée dans les conditions spécifiées.

La puissance d'entrée spécifiée P_i est appliquée sur le dispositif mesuré.

La puissance de sortie P_o est mesurée.

5.4.7 Conditions spécifiées

- Température ambiante ou température du point de référence
- Conditions de polarisation
- Fréquence
- Puissance d'entrée

5.5 Uniformité du gain (en puissance) (ΔG_p)

5.5.1 Objectif

Mesurer l'uniformité du gain en puissance dans les conditions spécifiées.

5.5.2 Schéma de circuit

Voir le schéma de circuit représenté sur la Figure 1.

5.5.3 Principe de mesure

Voir le principe de mesure en 5.2.3.

L'uniformité du gain en puissance est obtenue au moyen de l'équation suivante:

$$\Delta G_p = G_{p\max} - G_{p\min} \quad (5)$$

dans laquelle $G_{p\max}$ et $G_{p\min}$ sont le gain en puissance maximal et le gain en puissance minimal dans la bande de fréquences spécifiée à la puissance d'entrée spécifiée, respectivement.

5.5.4 Description et exigences du circuit

Voir la description et les exigences du circuit en 5.2.4.

5.5.5 Précautions à prendre

Voir les précautions à prendre en 5.2.5.

5.5.6 Procédure de mesure

Il convient de régler la fréquence du générateur de signaux à la valeur spécifiée.

La polarisation est appliquée dans les conditions spécifiées.

La puissance d'entrée P_i est appliquée sur le dispositif mesuré.

La puissance de sortie P_o est mesurée.

Le gain en puissance est calculé au moyen de l'équation (3).

La fréquence dans la bande de fréquences spécifiée présente une variation continue avec le même niveau de puissance d'entrée.

Obtenir le gain en puissance maximal $G_{p\max}$ et le gain en puissance minimal $G_{p\min}$ dans la bande de fréquences spécifiée.

L'uniformité du gain en puissance est obtenue au moyen de l'équation (5).

5.5.7 Conditions spécifiées

- Température ambiante ou température du point de référence
- Conditions de polarisation
- Bande de fréquences
- Puissance d'entrée

5.6 Réduction du gain (maximum disponible) (ΔG_{red})

5.6.1 Objectif

Mesurer la réduction du gain d'un amplificateur à commande automatique de gain (CAG) dans les conditions spécifiées.

5.6.2 Schéma de circuit

Voir le schéma de circuit représenté sur la figure 1, dans lequel l'alimentation de polarisation contient une polarisation de la CAG.

5.6.3 Principe de mesure

Voir le principe de mesure en 5.2.3.

5.6.4 Description et exigences du circuit

Voir la description et les exigences du circuit en 5.2.4.

5.6.5 Précautions à prendre

Voir les précautions à prendre en 5.2.5.

5.6.6 Procédure de mesure

Il convient de régler la fréquence du générateur de signaux à la valeur spécifiée.

La polarisation est appliquée dans les conditions spécifiées.

La polarisation CAG est réglée aux valeurs spécifiées, pour donner le gain linéaire maximal G_{linmax} .

Une puissance d'entrée suffisante est appliquée sur le dispositif mesuré.

En faisant varier la puissance d'entrée, confirmer que la variation de la puissance de sortie en dBm est identique à celle de la puissance d'entrée.

Le gain mesuré dans la région où la variation de la puissance de sortie est identique à celle de la puissance d'entrée est le gain linéaire maximal G_{linmax} .

La polarisation CAG est réglée à la valeur spécifiée, pour donner le gain linéaire minimal G_{linmin} .

Le gain linéaire minimal G_{linmin} est mesuré en dB de la même manière que ce qui est indiqué ci-dessus.

$$\Delta G_{\text{red}} = G_{\text{linmax}} - G_{\text{linmin}} \quad (6)$$

5.6.7 Conditions spécifiées

- Température ambiante ou température du point de référence

- Conditions de polarisation
- Fréquence
- La polarisation CAG donnant le gain linéaire maximal et le gain linéaire minimal

5.7 Puissance de sortie limite ($P_{o(ltg)}$)

Uniformité de la puissance de sortie limite ($\Delta P_{o(ltg)}$)

5.7.1 Objectif

Mesurer la puissance de sortie limite et l'uniformité de la puissance de sortie limite dans les conditions spécifiées.

5.7.2 Schéma de circuit

Voir le schéma de circuit représenté sur la figure 1.

5.7.3 Principe de mesure

Voir le principe de mesure en 5.2.3.

5.7.4 Description et exigences du circuit

Voir la description et les exigences du circuit en 5.2.4.

5.7.5 Précautions à prendre

Voir les précautions à prendre en 5.2.5.

5.7.6 Procédure de mesure

Il convient de régler la fréquence du générateur de signaux à la valeur spécifiée.

La polarisation est appliquée dans les conditions spécifiées.

La puissance d'entrée P_i est appliquée sur le dispositif mesuré.

La puissance de sortie P_o est mesurée.

En faisant varier la puissance d'entrée entre les limites inférieure et supérieure de la plage limite, trouver les puissances de sortie minimale et maximale ($P_{o(ltg,min)}$ et $P_{o(ltg,max)}$).

La puissance de sortie limite ($P_{o(ltg)}$) et l'uniformité de la puissance de sortie limite ($\Delta P_{o(ltg)}$) sont obtenues au moyen des équations suivantes:

$$P_{o(ltg)} = P_{o(ltg,max)} \quad (7)$$

$$\Delta P_{o(ltg)} = P_{o(ltg,max)} - P_{o(ltg,min)} \quad (8)$$

5.7.7 Conditions spécifiées

- Température ambiante ou température du point de référence
- Conditions de polarisation
- Fréquence
- Limite inférieure de la plage limite
- Limite supérieure de la plage limite

5.8 Puissance de sortie (P_o)

5.8.1 Objectif

Mesurer la puissance de sortie dans les conditions spécifiées.

5.8.2 Schéma de circuit

Voir le schéma de circuit représenté sur la figure 1.

5.8.3 Principe de mesure

Voir le principe de mesure en 5.2.3.

5.8.4 Description et exigences du circuit

Voir la description et les exigences du circuit en 5.2.4.

5.8.5 Précautions à prendre

Voir les précautions à prendre en 5.2.5.

5.8.6 Procédure de mesure

Il convient de régler la fréquence du générateur de signaux à la valeur spécifiée.

Les conditions de polarisation spécifiées sont appliquées.

La puissance d'entrée est appliquée avec la valeur spécifiée sur le dispositif mesuré.

La puissance de sortie est mesurée.

5.8.7 Conditions spécifiées

- Température ambiante ou température du point de référence
- Conditions de polarisation
- Bande de fréquences
- Puissance d'entrée

5.9 Puissance de sortie pour une compression de gain de 1 dB ($P_{o(1dB)}$)

5.9.1 Objectif

Mesurer la puissance de sortie pour une compression de gain de 1 dB dans les conditions spécifiées.

5.9.2 Schéma de circuit

Voir le schéma de circuit représenté sur la figure 1.

5.9.3 Principe de mesure

Voir le principe de mesure en 5.2.3.

La puissance de sortie pour une compression de gain de 1 dB $P_{o(1dB)}$, est la valeur pour laquelle le gain diminue de 1 dB, par rapport au gain linéaire.

5.9.4 Description et exigences du circuit

Voir la description et les exigences du circuit en 5.2.4.

5.9.5 Précautions à prendre

Voir les précautions à prendre en 5.2.5.

5.9.6 Procédure de mesure

Il convient de régler la fréquence du générateur de signaux à la valeur spécifiée.

La polarisation est appliquée dans les conditions spécifiées.

Une puissance d'entrée suffisante est appliquée sur le dispositif mesuré.

En faisant varier la puissance d'entrée, confirmer que la variation de la puissance de sortie en décibels est identique à celle de la puissance d'entrée.

Le gain mesuré dans la région où la variation de la puissance de sortie en décibels est identique à celle de la puissance d'entrée est le gain linéaire G_{lin} .

La puissance d'entrée est augmentée jusqu'à ce que le gain diminue de 1 dB par rapport au gain linéaire G_{lin} .

La puissance de sortie est mesurée au point de compression de gain de 1 dB.

5.9.7 Conditions spécifiées

- Température ambiante ou température du point de référence
- Conditions de polarisation
- Fréquence

5.10 Facteur de bruit (F)

5.10.1 Objectif

Mesurer le facteur de bruit dans les conditions spécifiées.

5.10.2 Schéma de circuit

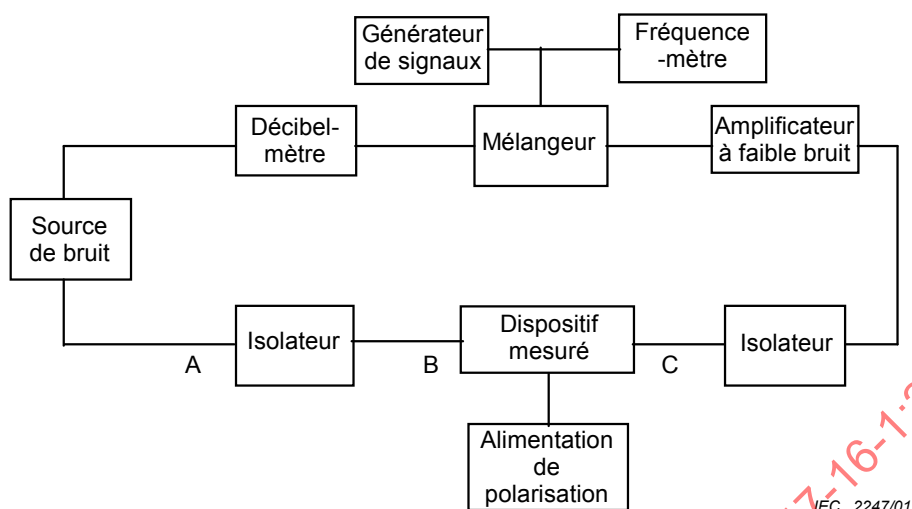


Figure 2 – Circuit de base pour la mesure du facteur de bruit

5.10.3 Principe de mesure

Le facteur de bruit F du dispositif mesuré est calculé au moyen de l'équation suivante:

$$F = 10 \log \left[10^{(F_{12} - L_1) / 10} \cdot \frac{10^{(F_2 / 10)} - 1}{10^{(G_{lin} / 10)} - 1} \right] \quad (9)$$

dans laquelle

F_{12} est le facteur de bruit global;

L_1 est la perte de circuit du point A au point B;

F_2 est le facteur de bruit après le point C au niveau de la sortie;

G_{lin} est le gain linéaire du dispositif mesuré;

F_{12} , F_2 , G_{lin} et L_1 sont exprimés en dB.

La mesure du facteur de bruit est réalisée en utilisant la méthode de mesures chaude et froide.

F_{12} , F_2 et G_{lin} sont calculés comme suit:

$$F_{12} = 10 \log \left(\frac{10^{ENR/10}}{(P_{N1} / P_{N2}) - 1} \right) \quad (10)$$

$$F_2 = 10 \log \left(\frac{10^{ENR/10}}{(P_{N3} / P_{N4}) - 1} \right) \quad (11)$$

$$G_{lin} = 10 \log \left(\frac{P_{N1} - P_{N2}}{P_{N3} - P_{N4}} \right) \quad (12)$$

dans laquelle

ENR est le rapport de bruit excédentaire de la source de bruit exprimée en décibels;

P_{N1} et P_{N2} exprimés en watts, sont les puissances de bruit mesurées respectivement dans les états chaud et froid de la source de bruit;

P_{N3} et P_{N4} exprimés en watts, sont les puissances de bruit mesurées respectivement dans les états chaud et froid de la source de bruit, dans le cas où le point A est directement connecté au point C de la figure 2.

La température de la mesure est 290 K.

5.10.4 Description et exigences du circuit

Il convient de mesurer au préalable la perte de circuit L_1 .

5.10.5 Précautions à prendre

La totalité du circuit doit être protégée contre les interférences électromagnétiques et mise à la terre pour empêcher l'influence de signaux parasites. Pour la mesure du facteur de bruit dans la condition de la bande latérale unique, l'image et les autres réponses parasites qui sont produites par le mélangeur requièrent une attention toute particulière.

Il convient de réduire ces réponses parasites de manière à ce qu'elles deviennent négligeables.

5.10.6 Procédure de mesure

La fréquence du générateur de signaux est ajustée à la condition spécifiée.

Pour mesurer la contribution en bruit du système de mesure, connecter le point A au point C sur la figure 2 sans le dispositif à mesurer.

Les puissances de bruit P_{N3} et P_{N4} , correspondant respectivement aux sources de bruit chaude et froide sont mesurées.

Le dispositif mesuré est inséré de la manière indiquée sur la figure 2.

La polarisation est appliquée dans les conditions spécifiées.

Mesurer les puissances de bruit P_{N1} et P_{N2} , correspondant respectivement aux sources de bruit chaude et froide.

Le facteur de bruit, en décibels, est calculé au moyen de l'équation (9).

NOTE Régler l'impédance d'entrée et de sortie du dispositif mesuré pour qu'elles coïncident, s'il y a lieu.

5.10.7 Conditions spécifiées

- Température ambiante ou température du point de référence
- Conditions de polarisation
- Fréquence
- Bande latérale simple ou bande latérale double

5.11 Distorsion d'intermodulation (à deux tonalités) (P_n/P_1)

5.11.1 Objectif

Mesurer la distorsion d'intermodulation dans les conditions spécifiées.

5.11.2 Schéma de circuit

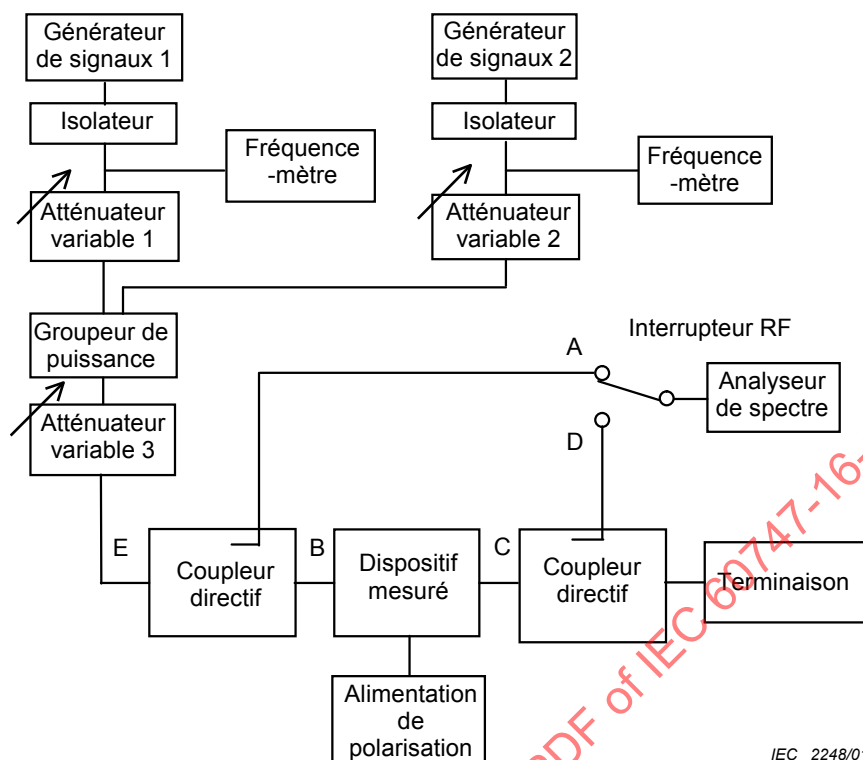


Figure 3 – Circuit de base pour les mesures de la distortion d'intermodulation à deux fréquences porteuses

5.11.3 Principe de mesure

Dans le schéma de la figure 3, la puissance d'entrée P_i et les puissances de sortie P_0 et P_n du dispositif mesuré sont obtenues au moyen des équations suivantes:

$$P_i = P_a + L_1 \quad (13)$$

$$P_o = P_b + L_2 \quad (14)$$

$$P_n = P_c + L_2 \quad (15)$$

dans lesquelles

P_0 et P_n sont respectivement les puissances du signal de la composante fondamentale et de la distortion d'intermodulation;

P_a , P_b et P_c sont les valeurs indiquées par l'analyseur de spectre correspondant respectivement à P_i , P_0 et P_n ;

L_1 est la différence entre les pertes L_A et L_B où L_A est la perte du point E au point A et L_B est la perte du point E au point B indiquées sur la figure 3, respectivement. L_2 est la perte de circuit du point C au point D indiquée sur la figure 3. P_i , P_1 , P_n , P_a , P_b et P_c sont exprimés en dBm. L_1 et L_2 sont exprimés en décibels.

La distortion d'intermodulation, P_n/P_1 , qui est exprimée en dBc, est obtenue au moyen des équations (14) et (15) comme suit:

$$P_n/P_1 = P_n - P_0 = P_c - P_b \quad (16)$$

5.11.4 Description et exigences du circuit

Voir la description et les exigences du circuit en 5.2.4.

L'atténuateur variable 3 peut être éliminé.

5.11.5 Précautions à prendre

Voir les précautions à prendre en 5.2.5.

Il est recommandé de raccorder le port D, lorsque l'interrupteur est connecté à la position A, et vice versa.

5.11.6 Procédure de mesure

La polarisation est appliquée dans les conditions spécifiées.

L'interrupteur est connecté à la position A.

Le générateur de signaux 1 est activé et le signal de la composante fondamentale est appliqué au dispositif mesuré, avec le niveau spécifié P_i , au moyen de l'analyseur de spectre et de l'atténuateur variable 1.

Le générateur de signaux 2 est activé et un autre signal est ajouté sur le dispositif mesuré, avec le même niveau que le signal de la composante fondamentale, au moyen de l'analyseur de spectre et de l'atténuateur variable 2.

L'interrupteur est connecté à la position D.

Les puissances de sortie P_b et P_c en dB du signal de la composante fondamentale et des produits d'intermodulation sont mesurées au moyen de l'analyseur de spectre.

La distorsion d'intermodulation pour la puissance d'entrée spécifiée P_i est obtenue au moyen des équations (13) à (16).

5.11.7 Conditions spécifiées

- Température ambiante ou température du point de référence
- Conditions de polarisation
- Puissance d'entrée
- Fréquences

5.12 Puissance au point d'interception (pour les produits d'intermodulation) ($P_{n(IP)}$)

5.12.1 Objectif

Mesurer la puissance au point d'interception pour les produits d'intermodulation dans les conditions spécifiées.

5.12.2 Schéma de circuit

Voir le schéma de circuit en 5.11.2.

5.12.3 Principe de mesure

Voir le principe de mesure en 5.11.3.

5.12.4 Description et exigences du circuit

Voir la description et les exigences du circuit en 5.11.4.

5.12.5 Précautions à prendre

Voir les précautions à prendre en 5.11.5.

5.12.6 Procédure de mesure

La polarisation est appliquée dans les conditions spécifiées.

L'interrupteur est connecté à la position A.

Le générateur de signaux 1 est activé et le signal de la composante fondamentale est appliqué au dispositif mesuré, avec le niveau spécifié, au moyen de l'analyseur de spectre et de l'atténuateur variable 1.

Le générateur de signaux 2 est activé et un autre signal est appliqué au dispositif mesuré, avec le même niveau que le signal de la composante fondamentale, au moyen de l'analyseur de spectre et de l'atténuateur variable 2.

L'interrupteur est connecté à la position D.

Les puissances de sortie du signal de la composante fondamentale et les produits d'intermodulation spécifiés sont mesurés au moyen de l'analyseur de spectre.

Pour changer le niveau de puissance des signaux d'entrée au moyen de l'atténuateur variable 3, la procédure ci-dessus est renouvelée dans la gamme spécifiée.

Les données obtenues sont tracées.

Les lignes droites du signal de la composante fondamentale et des produits d'intermodulation dans la région linéaire sont étendues.

La puissance de sortie au point d'interception des deux lignes étendues est la puissance au point d'interception pour les produits d'intermodulation, c'est-à-dire de deuxième ordre, de troisième ordre, etc., dans les conditions spécifiées requises en 5.12.7.

5.12.7 Conditions spécifiées

- Température ambiante ou température du point de référence
- Conditions de polarisation
- Puissance d'entrée
- Fréquences
- Plage de puissance d'entrée

5.13 Amplitude du coefficient de réflexion d'entrée (affaiblissement de réflexion d'entrée) ($|S_{11}|$)

5.13.1 Objectif

Mesurer l'amplitude du coefficient de réflexion d'entrée (affaiblissement de réflexion d'entrée) dans les conditions spécifiées.